

CENTRO H₂O⁻ EM HALETOS ALCALINOS COM OH⁻: PROPRIEDADES E CINÉTICA DE FORMAÇÃO - DESTRUIÇÃO POSTERIOR AO DANO DE RADIAÇÃO

Laércio Gomes

DISSERTAÇÃO E TESE-IEA 108 IEA · DT · 108

MARÇO/1979

CONSELHO DELIBERATIVO

MEMBROS

Klaus Reinach — Presidente Roberto D'Utra Vaz Helcio Modesto da Costa Ivano Humbert Marchesi Admar Cervellini

PARTICIPANTES

Regina Elisabete Azevedo Beretta Flávio Gori

SUPERINTENDENTE

Rômulo Ribeiro Pieroni

MARÇO/1979

DISSERTAÇÃO E TESE - IEA IEA - DT - 108

•

CENTRO H₂O⁻ EM HALETOS ALCALINOS COM OH⁻: PROPRIEDADES E CINÉTICA DE FORMAÇÃO -- DESTRUIÇÃO POSTERI - : AO DANO DE RADIAÇÃO

Laércio Gomes

Dissertação para obtanção do Título de "Mestre em Ciências — Área de Concentração: Tecnologia Nuclear" — Orientadur Dr. Spero P. Morato. Apresentada e defendida em 06 de junho de 1978, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo.

> INSTITUTO DE ENERGIA ATÔMICA SÃO PAULO - BRASIL

Série DISSERTAÇÃO E TESE IEA

INIS Categories and Descriptors

,

A13

Hydroxides Potassium chlorides Potassium bromides Crystal defects Color centers

Absorption spectroscopy

Nota: A redação, ortografia e conceitos são de responsabilidade dos autores.

SUMÁRIO

CAPITULO I

INTRODUÇÃO	 1

CAPITULO II

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DANO POR RADIAÇÃO DE BAIXA ENERGIA NOS HALETOS ALCALINOS	2
II.1 – Produtos Primários do Efeito da Radiação a Baixa Temperatura nos Cristais Iônicos	3
II.1.1 – Formação de Centros H e F (T < 10K)	3
 II.2 – As Principais Propriedades do Centro OH⁻	5 6
II.3.1 – Fluorescência do OH ⁻	6 6 7
II.4 – O Centro U ₂ e suas Principais Propriedades	7 8

CAPÍTULO III

PROCE	DIMENTO EXPERIMENTAL, I	EQI	UIF	PA	M	EN	T(וכ	E	PR	EF	PA	R/	١Ç	Ã	D	DA	S	A	M	DS	T	RA	۱S	•	•	8
111.1 – 1	Equipamento Experimental									•							•	•				•					8
III.2 – I	Criostato e Porta Amostra							•		•																	10
.3	Preparação das Amostras																	•									10
111.4 1	Medida e Controle de Temperat	tura								•							•	•					•				12
III. 5 – I	Medidas de Absorção Óptica .																										12
 .6 –	Métodos de Irradiação									•								•									13
111 .7 – 1	Tratamento Térmico				•			•		•							• •	•					•				15
	1 – Acompanhamento Dinâmic	ο.																									15
	2 – Tratamento Térmico Pulsac	ю												•													15

CAPITULO IV

RESULTADOS E CONCLUSÕES	15
IV.1 Comportamento Termodinâmico dos Produtos e Sub-Produtos do OH ⁻	17
IV.1.1 – Energias de Ativação	24

ERRATA

CENTRO H₂O⁻ EM HALETOS ALCALINOS COM OH⁻: PROPRIEDADES E CINÉTICA DE FORMAÇÃO - DESTRUIÇÃO POSTERIOR AO DANO DE RADIAÇÃO

IEA - DT - 108 - Margo/1979

Página 58 - Linha 35

Onde se M

após a destruição térmica do centro $H_3O^{-}\partial f^* ::f^* f^* gf: I + *$

Leis-ee

após a destruição térmica do centro H2O°. Para que se produza a reconstituição acima mencionada no

Página

IV.1.2 — Destruição do Centro U ₂	29
IV.1.3 — Formação e Destruição do Centro H ₂ O ⁻	30
IV.1.4 — Formação de Centros F e U e Reconstituição do OH	30
IV.1.5 — Mecanismos e Modelo	31
IV.1.5.1 — Estágio I em KBr	31
IV.1.5.2 — Estágio III em KBr	34
IV.1.5.3 — Estágio III (KCI) e IV (KBr)	37
IV.1.5.4 — Reconstituição dos Centros OH ⁻	39

CAPÍTULO V

RESULTADOS E CONCLUSÕES II	40
V.1 – Generalidades	40 43
V.2.1 – Estudo com a Temperatura	43
V.3 - Fotodissociação do Centro H2O" em KCl	46
V.3.1 — Fotodissociação a 77K V.3.2 — Estudo da Fotodissociação do H2O ⁻ com a Temperatura	48 54
V.4 — Modelo para o Centro H ₂ O ⁻	57
V.4.1 — Modelo Proposto por Rusch e Seidel	57 58
APÊNDICE A	60
APÊNDICE B	61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65

CENTRO H₂O⁻ EM HALETOS ALCALINOS COM OH⁻: PROPRIEDADES E CINÉTICA DE FORMAÇÃO – DESTRUIÇÃO POSTERIOR AO DANO DE RADIAÇÃO

Laércio Gomes

RESUMO

Com a finalidade de se compreender os mecanismos básicos responsáveis pela formação térmica e destruição térmica dos defeitos primários e secundários, apôs o dano por radiação de baixa energia nos haletos alcalinos com OH⁻, estudou-se a produção desses defeitos por tratamentos térmicos pulsados em cristais de KCI:OH⁻ e KBr:OH⁻.

Esses processos térmicos forum estudados no intervalo de temperatura de 52 a 300 K, e os vérios produtos das reações com hidrogênio foram identificados pela sua absorção eletrônica (visívei – ultravioleta) característica. Além dos defeitos $H_i^0 \in H^-$ conhecidos, foi descoberto um novo defeito de hidrogênio, o centro U_{2x} , que é um produto de destruição térmica dos centros U₂. Ele é caracterizado por ume nova banda de absorção eletrônica (UV) sem estrutura, localizada em 45000 cm⁻¹ em KCI e 40000 cm⁻¹ em KBr. Das observações experimentais foi proposto que: o centro U_{2x} é constituído por um centro H_i^0 aprisionado pelo fon substitucional OH⁻, sem alterar a transição eletrônica deste (on OH⁻. A destruição térmica dos centros U_{2x} produz: centros H_2O^- em KCI e centros H_2O^- e U em KBr. Por outro lado, foi observado que a destruição térmica dos centros H_2O^- produz: centros F(15%), U(60%) e OH⁻ (25%) em KCI e centros F(~ 100%) em KBr. No final desse processo térmico são restaurados, às custas dos centros F e U, 90 a 95% doe centros OH⁻ inicialmente destruídos.

Várias propriedades novas do defeito H_2O^- foram encontradas e estudadas. Uma delas é a fotodissociação, à temperatura de nitrogênio Ilquido, do centro H_2O^- por irradiação na sua banda de absorção eletrônica, produzindo um centro U_2 e um centro OH⁻. Utilizando-se esse propriedade, calculou-se a intensidade de oscilador total da benda H_2O^- (no visível) em KCI ($f_{H_2O}^{-=}0,62$), por método comparativo. A estrutura da benda H_2O^- (no visível) foi decomposta e melhor ajustada por soma de 5 gaussianas. Foram observadas também, mudenças nas intensidades relativas das transições eletrônicas do centro H_2O^- , indicando possíveis modificações de simetria do defeito. Detetou-se uma banda de absorção na região do infravermento, localizada em 1410 cm⁻¹ em KCI que foi atribuída à excitação de um modo local do centro H_2O^- . Com apoio dos resultados dos processos térmicos e das novas propriedades observadas, proposes que o centro H_2O^- : a constitui de um centro F fortemente perturbado, contendo uma molécula de OH com um átomo de hidrogênio aprisionado.

I - INTRODUÇÃO

Na tecnologia dos materiais nucleares ou dosimétricos um dos sérios problemas encontrado é o da compreensão dos mecanismos básicos envolvidos na formação dos defeitos (e suas propriedades) provocados pela radiação⁽³⁰⁾. Nesse sentido, a física dos centros de cor tem desempenhado papel importante em virtude de sua aplicação em materiais tais como UO₂, ThO₂, UC, BeO⁽²⁹⁾ que apresentam estruturas cristalinas similares aos haletos alcalinos. Levando em conta a complexidade dessas estruturas cristalinas e também dos defeitos nelas produzidos é conveniente utilizar materiais modelo simples para realizar tais estudos cujos resultados podem facilmente ser extrapolados para materiais mais

Aprovada para publicação em Junho/1978.

complexos. É com esse propósito que resolvemos estudar os mecanismos básicos envolvidos na formação dos defeitos primários e secundários pela fotodissociação da impureza substitucional OH⁻ nos haletos alcalinos. A escolha dessa impureza se deve ao fato que o OH⁻ se fotodissocia sob radiação UV produzindo centros de hidrogênio e oxigênio ou mesmo combinações destes centros com outros defeitos de interesse como no caso da molécula de água aprisionada por um centro F, envolvendo mecanismos simples e radiação de baixa energia.

Os haletos alcalinos são bons materiais modelos para esses estudos pois além de possuírem estrutura cristalina relativamente limples pode-se facilmente detectar por absorção óptica os defeitos produzidos que apresentam transições eletrônicas ou vibracionais na banda proibida (transparente) do cristal, situando-se entre a absorção dos fonons TO da rede e a primeira absorção de excitons.

A impureza substitucional OH⁻ é observada em todos os haletos alcalinos naturais e sintéticos crescidos no ar. A sua presença mesmo em quantidades pequenas (~ 10^{-5} cm⁻³) produz pronunciados efeitos sobre muitas propriedades físicas do cristal, tais como: ópticas^(6,31), dielétricas⁽¹⁴⁾, elásticas⁽¹⁾, condutividade iônica⁽¹⁰⁾ e térmica⁽¹⁸⁾, fotoquímica^(2,17) e danos por radiação⁽²⁴⁾. Além disso, ele exibe momentos de dipolos elétricos⁽²²⁾ e elásticos⁽²⁷⁾ dando como consequência fenômenos de alinhamento paraelétrico⁽¹⁵⁾ e paraelástico⁽¹¹⁾ sob aplicações de campos elétrico e mecânico (stress) respectivamente. Tais fenômenos tem estimulado estudos do defeito OH⁻ principalmente no seu estado eletrônico fundamental. Suas propriedades e comportamento no estado excitado são pouco conhecidos.

Como o OH⁻ fotodissocia-se sob irradiação UV à temperaturas abaixo de 200K, ele constitui uma fonte direta de átomos e íons de hidrogênio que podem ocupar posições substitucionais ou intersticiais no cristal. As impurezas de hidrogênio nos haletos alcalinos desempenham um papel importante nos estudos dos defeitos em geral, pois fornecem grandes quantidades de informações sobre os mecanismos básicos envolvidos na formação e destruição dos defeitos sob irradiação. Impurezas de hidrogênio além de serem as mais simples imperfeições extrínsecas que se pode encontrar nos materiais, são excelentes testes para modelos quanto-mecânicos de defeitos em cristais. Além de sua fácil identificação por absorção ótpica eletrônica no ultravioleta⁽⁵⁾ pode-se observar também as impurezas de hidrogênio por suas transições vibracionais em modos localizados no "Gap"^(9,34). Essas transições vibracionais que são geralmente ativas no infravermelho localizam-se energeticamente acima do ramo TO dos fonons da rede em virtude da pequena massa do átomo de hidrogênio. Em cartos casos o caráter magnético de defeitos de hidrogênio pode também ser estudado por técnicas magnéticas⁽¹²⁾.

II – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DANO POR RADIAÇÃO DE BAIXA ENERGIA NOS HALETOS ALCALINOS

Quando um cristal iônico é exposto à radiação, numerosas mudanças podem ocorrer canto nos fons da rede como nas impurezas que estiverem presentes. Os produtos finais dessas mudanças são classificados em termos de três categorias de defeitos ⁽²⁵⁾:

- 1) Defeitos Eletrônicos; que envolvem mudanças nos estados eletrônicos de valência.
- 2) Defeitos lônicos ; que resultam de deslocamentos de (ons da rede.
- 3) Imperfeições grosseiras ; tais como deslocações e vazios (voids).

Os mecanismos pelos quais esses defeitos podem ser produzidos resumem-se nas seguintes classes⁽³⁵⁾: processos eletrônicos, colisões elásticas e radiólise. A classe dos procescos eletrônicos inclui todos os processos onde um estado eletrônico é alterado ou uma carga é deslocada pela absorção da energia radiante, mas sem envolver a formação de defeitos atômicos ou iônicos. Na classe das colisões elásticas os átomos ou (ons são deslocados devido a transferência de momento e energia pelas pestículas incidentes. Pelo processo de radiolise são produzidos os defeitos atômicos ou iônicos como um resultado final de uma série de reações iniciadas com uma excitação eletrônica. Essas reações preliminares envolvem três etapas:

- A excitação eletrônica provoca momentaneamente a criação de um defeito eletrônico carregado, na rede.
- 2) Há uma conversão dessa energia de excitação em energia cinética para um (on da rede.
- 3) O fon move-se e se estabiliza num ponto da rede.

II.1 - Produtos Primários do Efeito da Radiação a Baixa Temperatura nos Cristais Iônicos

Por radiólise a radiação ultravioleta ionizante é capaz de provocar a baixas temperaturas (T < 10K) a formação dos defeitos Frenkel que são os produtos primários da radiação na sub-rede aniônica dos haletos alcalinos. Dois tipos de defeitos aniônicos são formados: pares Frenkel carregados; constituído de uma vacância de anion (-) e um anion intersticial (com índice i), cuja reação de formação é a seguinte: $CI^- + h\nu \rightarrow (-) + CI^-_i(1)$ e pares Frenkel neutros; constituído por uma vacância de anion (centro F) e um átomo intersticial de cloro (centro H), cuja reação de formação é a seguinte:

$$Cl^{-} + h\nu \longrightarrow e^{+} Cl_{i}^{0}$$
(2)

Geralmente são considerados os pares neutron Frenkul como os produtos primários do efeito da radiação. A seguir descreveremos o processo de formação dos centros F e i! como é presentemente aceito a título de ilustração de um processo elementar típico de dano de radiação num cristal iônico.

II.1.1 -- Formação de Centros H e F (T < 10 K)^(13,35,38)

Raios X ou UV ionizam um (on de halogênio da sub-rede aniônica produzindo primeiramente elétrons e buracos livies. O buraco livre é imediatamente localizado no espaço de momentos provocando uma relaxação dos (ons ao seu redor tornando-se um buraco auto-aprisionado na configuração de um (on molecular X₂⁻, também conhecido como o centro V_K. O elétron livre inicialmente produzido perde energia cinática por excitações de fonons ópticos, etc, sendo finalmente aprisionado pelo centro V_K. O elétron inicialmente ocupa os níveis mais energéticos e decai rapidamente para o nível excitado de energia mais baixa do centro V_K, o estado 2 Pz. No centro V_K os dois (on: de halogênio estão mais próximos um do outro do que na rede normal, formando uma especie de duas semivacâncias (cada uma com carga efetiva $\frac{+|e|}{2}$, sendo atrativa para elétrons) na direção <110>, com o (on molecular entre elas. O estado 2 Pz é o estado excitado menos energético porque está localizado ao longo da direção <110> utilizando a região de potencial atrativo das duas semivacâncias.

Conforme podemos observar na Figura 1, a transição do elétron 2 Pz para o estado 1s pode ocorrer por dois caminhos; transição radioativa e não radioativa.

Transição não radioativa: - O elétron 2 Pz enquanto relaxa empurra o fon molecular para uma das semivacâncias, ficando portanto inteiramente localizado na semivacância oposta. Em virtude da maior afinidade eletrônica dessa vacância em relação às semivacâncias ccupadas pelo elétron 2 Pz, essa relaxação 2 Pz -+ 1s pode fornecer energia cinética suficiente para que a molécula X₂ mova-se na direção <110> numa sequência de colisões e reposições estabilizando-se afastado na semivacância ocupada pelo



Figura 1 — Diagrama Esquemático (Proposto por Toyozawa⁽³⁸⁾) dos Mecanismos Envolvidos na Formação de Defeitos em Haletos Alcalinos (T < 10 K), Submetidos a Radiação Ionizante



Figura 2 - Configuração dos Centros V_K, H, F em uma Rede do Tipo NaCl

elétron no estado 1s (centro F), na forma de um "crowdion" (centro H). Pode ocorrer também que a molécula não receba energia cinética para mover-se, resultando numa relaxação do sistema (F(1s) + H) para uma situação onde o elétron ocupa o estado 1s do centro V_K, conforme é indicado na Figure 1

Transição radioativa: – O elétron $2p_z$ do centro V_K emite um foton de energia aproximadamente 2 eV indo para o estado 1s do mesmo. Finalmente o sistema composto pelo elétron 1s mais centro V_K decai por emissão luminescente e a rede recompõe-se.

É importante notar que existem dois canais competindo; um conduzindo à formação de centros de cor (centros F e H) e o outro conduzindo à luminescência intrínseca e portanto não produzindo defeitos na rede (Figura 2).

II.2 - As principais Propriedades do Centro OH⁻

As impurezas OH⁻ quando incorporados substitucionalmente nos haletos alcalinos dão quatro tipos de absorção óptica: eletrônica, vibracional, rotacional e libracional^(5,9,34). A absorção eletrônica origina a formação de uma banda de absorção localizada na região espectral do ultravioleta, próxima à absorção fundamental eletrônica do cristal, larga e sem estrutura, apresentando um pequeno estreitamento à baixas temperaturas. A intensidade de oscilador varia entre 0,1 e 0,2 (para sete haletos alcalinos diferentes). Esses pequenos valores para a intensidade de oscilador da banda UV permitem a conclusão de que devem existir mais transições envolvendo energias maiores mas que são encobertas pelas bandas de exciton do cristal⁽³⁹⁾.

A posição do máximo da banda segue a relação empírica de Molwo-lvey que relaciona a distância d entre os vizinhos mais próximos e a frequência do máximo da banda⁽⁶⁾: $v_{max} = 691d^{0.95}$ (3). Uma relação línear desse tipo reforça o argumento de Köstlin⁽²¹⁾ que assume ser a banda de absorção ultravioleta do OH⁻ devida a uma transição eletrônica análoga a que ocorre na primeira absorção de excitons nos cristais haletos alcalinos⁽¹⁶⁾. Para o espectro de absorção de excitons, Hilsch e Pohl, consideram que o efeito primário da absorção de um foton é o da transferência de um elétron de um átomo de halogênio para um átomo alcalino vizinho mais próximo ou mecanismo de absorção por troca de carga. A energia requerida nesse processo é dada por⁽¹⁹⁾ $h\nu = E_A - E_I + \frac{\alpha_M e^2}{\Gamma_o}$ (4) onde E_A é a afinidade elecrônica do halogênio, E_I a energia de ionização do átomo alcalino, $\alpha_{\rm M}^{\prime}$ a constante de Madelung e $\Gamma_{\rm o}$ a distância entre os vizinhos mais próximos. Essa relação tem sido usada para predizer as posições das bandas de absorção óptica provocadas por impurezas dos (ons de halogênios⁽²⁵⁾. Considerando a equivalência entre o número de elétrons da camada mais externa do fon OH⁻e do fon de halogênio é assumido um processo análogo para a absorção UV do OH". Kapphan⁽¹⁶⁾ calculou as posições dos máximos das bandas de absorção UV do OH" para onze haletos alcalinos, com base nesse modelo de transferência de carga, utilizando a equação (4) e comparou com os valores calculados pela relação de Molwo-Ivey (3) tendo obtido uma concordância dentro de 93%. Com base no modelo de transferência de carga pode-se explicar qualitativamente que a banda de absorção UV do OH⁻ se refere à transição eletrônica do estado fundamental do OH⁻ para o estado excitônico da rede. A sub-estrutura observada no espectro de emissão dos centros OH^{- (20,28)} refere-se à transições do estado eletrônico excitado para os diversos níveis vibracionais do estado eletrônico fundamental.

Cálculos teóricos da transição UV do (on OH⁻ efetuados por Chase e Dick⁽³⁾ utilizando a função de onda do estado eletrônico fundamental para o OH⁻livre e o modelo de transferência de carga, mostraram razoável concordância entre os valores das energias da transição calculados e os medidos, não explicando o fator de anisotropia g \approx 0,3 obtido experimentalmente.

A absorção vibracional⁽⁴⁾ do fon molecular OH⁻ consiste numa banda do infravermelho próximo (cerca de 2,7 μ) provocada pela excitação óptica do modo vibracional de "respiração" da molécula OH⁻. A absorção vibracional⁽⁴⁾ no infravermelho distante (~ 0,035 ev) pode ser interpretada como uma excitação óptica de uma vibração angular do (on OH⁻ ao redor das suas orientações de equil/brio na rede cristalina.

O defeito OH⁻ apresenta um momento de dipolo elétrico permanente podendo portanto ser orientado num campo elétrico apresentando fenômeno de dicroísmo elétrico⁽³⁹⁾. Isto significa que um campo elétrico induz diferenças no coeficiente de absorção para luz polarizada em diferentes direções e está diretamente relacionado ao comportamento paraelétrico dos dipolos. Qualquer centro substitucional possuindo dipolo elétrico pode ser assumido estar confinado pelo potencial cristalino em n direções de equilíbrio correspondendo classicamente a um estado fundamental orientacional n-vezes degenerado. Essa degenerescência é removida pela aplicação do campo elétrico e num temperatura de equilíbrio a população desses níveis será dada pela distribuição de Boltzmann. Excitações ópticas de um centro de dipolo produzem diferentes absorções quando os dipolos são excitados paralelamente ou perpendicularmente ao seu eixo (polarização σ ou π respectivamente). O alinhamento dos dipolos pelo campo elétrico aplicado deve produzir mudanças no coeficiente de absorção óptica. Essas mudanças foram medidas quantitativamente para a absorção eletrônica UV do OH⁻ e interpretadas como segue:

- O centro OH⁻ nos haletos alcalinos possui dipolo elétrico (p ~ 1eA) e está confinado pelo potencial cristalino nas seis direções <100>.
- A mesma transição eletrônica espectral realiza-se paralelamente (//) e perpendicularmente (1) ao eixo molecular com intensidade de oscilador diferente (f// f 1 ~ 0,3).

H.3 – Luminescência, Termoluminescência e Fotodissociação do Ion Substitucional OH⁻ nos Haletos Alcalinos

A excitação obvica da transição responsável pela banda de absorção UV conduz a um retôrno radioativo (luminescência) ou não radioativo $^{(20,28)}$ ou provoca a fotodisso ciação do fon OH $^{-(2,31)}$.

II.3.1 - Fluorescência do OH⁻

Kőstlin⁽²⁰⁾ concluiu que a fluorescência observada no KB_r: OH⁻ está relacionada com transições radioativas da molécula excitada. Como aos máximos mais intensos correspondem as energias maiores, esse fato sugere que as transições de emissão a partir de um estado excitado findam nos níveis vibracionais com n = 0, 1, 2, ... do estado fundamental da molécula. O desvio de Stokes observado é muito mais proveniente da relaxação da rede (após a excitação e emissão pela molécula) do que da calaxação molecular. É observado também um forte acoplamento dos estados eletrônicos da molécula com as vibrações da rede em virtude da largura da banda de emissão e do seu alargamento com a temperatura.

II.3.2 - Fotodissociação do OH-

Kerkhoff⁽¹⁷⁾ estudou a fotodissociação do OH⁻ e forneceu a primeira equação para o processo de dissociação;

$$\begin{array}{c} OH^{-} & \xrightarrow{h \nu (OH^{-})} \\ \hline T < 100 \text{ K} \end{array} H_{i}^{0} + O^{-} \end{array}$$
(5)

onde o símbolo 🗆 significa ocupação substitucional, e o índice i representa ocupação intersticial na rede. Uma fotodissociação correspondente á também observada nos haletos alcalinos dopados com (ons SH⁻ (12), SeH⁻ (7) e TeH⁻ (23).

A equação (5) é sustentada fortemente por medidas de ESR e ENDOR⁽⁵⁾ indicando sem dúvida a presença dos átomos de hidrogênio em posições intersticiais (centro U₂). O centro O⁻ possui uma banda de absorção eletrônica na região da absorção fundamental do cristal, não sendo possível estudá-lo por técnicas de absorção óptica. A sua estrutura microscópica ainda é uma incógnita. Os centros U₂ (H^o_i) e O⁻ são os produtos primários da fotodissociação do OH⁻ dependendo da técnica utilizada no processo de irradiação. Para obter-se os centros U₂ e O⁻ como os produtos finais do processo de dissociação do OH⁻ deve-se incidiar a amostra durante um intervalo de tempo relativamente curto, com luz monocromática na região próxima do máximo da absorção eletrônica do OH⁻. Expecisções longas e o uso de luz não monocromática produzem reações secundárias conduzindo à formação de centros como U, U₁, α , F, H, V₁^(2,31). Os centros U₂ produzidos na fotodissociação do OH⁻ tornam-se instáveis termicamente a temperaturas acima de 110K⁽¹⁷⁾ em KCI.

II.3.3 - Termoluminescência do OH-

Kőstlin⁽²⁰⁾ utilizando uma amostra de KB_r: OH⁻ encontrou um pico termoluminescente próxime de 145 K durante a destruição térmica dos centros U₂. Uma análise mais detalhada da curva do de caimento da absorção óptica dos centros U₂ e da termoluminescência, ambas registradas simultaneamente sob condição de aquecimento linear, revelaram que a intensidade luminescente é rigorosamente proporcional à razão do decaimento dos centros U₂. Observou também que a distribuição espectral dessa luminescência é idêntica à fluorescência do OH⁻ quando medida na temperatura do "annealling", concluindo finalmente que os átomos de hidrogênio (centro U₂) libertados de suas armadilhas intersticiais recombinam-se com os (ons O⁻ formando moléculas de OH⁻ no estado excitado e que, a seguir, se desexcitam por emissão luminescente. A eficiência observada nesse processo é de ~ 0,2 quanta luminescente por centro U₂ destruído (supondo que todo (OH⁻)^{*} (excitado) produzido se desexcite por emissão luminescente) deixando essa questão em aberto se a recombinação para formar moléculas (OH⁻)^{*} é o mecanismo predominante induzido pela instabilidade térmica dos centros U₂. Kőstlin⁽²⁰⁾ observou também um pequeno pico perto de 120K que depende do intervalo de tempo entre o término da irradiação (à T = 80K) e o início do "annealing".

II.4 - O Centro U₂ e suas Principais Propriedades

O defeito U₂ é basicamente um átomo neutro de hidrogênio ocupando uma posição intersticial na rede. Um KCI torna-se termicamente próximo de 110K migrando pelo cristal dando origem a novas imperfeições na rede⁽²⁶⁾. Ele pode ser reproduzido a partir da fotodissociação, em baixas temperaturas, de moléculas substitucionais XH⁻ nos haletos alcalinos, onde X representa os seguintes elementos: O, S, Se, Te. Vários estudos de absorção óptica⁽⁸⁾ e do espectro de ressonância⁽³⁶⁾ do U₂ na presença de vários anti-centros O⁻, S⁻, Se⁻ e Te⁻ não mostraram diferenças entre eles. Até o presente nada se sabe sobre uma possível interação entre o defeito U₂ e o seu anti-centro O⁻.

Quando aprisionado na posição intersticial o átomo de hidrogênio possui uma banda de absorção eletrônica na região do ultravioleta. A transição responsável por essa banda foi primeiramente descrita por Kerkhoff como a excitação de um buraco positivo que no estado eletrônico fundamental do centro U₂ está principalmente ligado ao hidrogênio e no estado excitado está ligado mais fortemente aos quatro fons de halogênios vizinhos mais próximos⁽²³⁾. Xurz⁽²³⁾ sugeriu que o primeiro processo a ocorrer após a excitação do U₂ é a relaxação não cúbica da rede onde o fon de hidrogênio desloca-se ao longo da direção <100> e os fons de halogênio na direção <110>. Inicialmente, o buraco é excitado opticamente, espalhando-se entre os fons de halogênio ;logo em seguida há uma relaxação não cúbica da rede provocando uma mudança no potencial e polarização da distribuição de carga tornando o buraco mais localizado. Nessa situação pode ocorrer ou uma aniquilação entre o vlétron e o buraco mais localizado restaurando a rede ou um escape a essa aniquilação conduzindo à formação de novas imperfeições.

II.5 - Objetivo

Tem-se como principal objetivo deste trabalho estudar e discutir os defeitos e mecanismos envolvidos na formação e destruição do defeito H_2O^- comparando com o que foi proposto por Rusch e Seidel⁽³³⁾. Será discutido também o modelo estrutural para o defeito H_2O^- proposto por Rusch e Seidel^(32,33), com base em estudos de absorção óptica e fotodissociação do H_2O^- . Portanto nos capítulos a seguir serão abordados principalmente os seguintes aspectos:

Estudo Termodinâmico do H₂O⁻

- cinética de formação.
- produção de H₂O⁻em diversos haletos alcalinos.
- cinética de destruição e formação ce centros F.

Propriedades ópticas do H₂O⁻

- espectro de absorção óptica eletrônica e sua estrutura nos diversos haletos alcalinos.
- mudança da forma e dos máximos da banda em função de T.
- absorções infravermelhas de modos vibracionais localizados e efeito isotópico,
- fotodissociação do H₂O⁻e sua dependência com a temperatura.

III - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL, EQUIPAMENTO E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

A necessidade de medidas ópticas a baixas temperaturas advém dos seguintes motivos:

- 1) OH⁻ fotodissocia-se efetivamente somente em temperaturas abaixo de 150K⁽²⁶⁾.
- 2) O centro U₂ é termicamente estável abaixo de 100K para a maioria dos haletos alcalinos.
- 3) O centro H2O⁻é termicamente estável abaixo de 250K.

III.1 -- Equipamento Experimental

Montou-se um arranjo experimental móvel capaz de produzir temperaturas baixas na amostra a ser estudada com técnicas ópticas. Um esquema dessa montagem com os conjuntos descritos a seguir pode ser visto na Figura 3. Este arranjo compõe-se do seguinte:

- 1) Sistema de vácuo
- 2) Sistema de gás de troca



Figura 3 – Esquema da Montagem do Equipamento para Medidas de Absorção Óptica a Baíxa Temperatura. (1) Sistema de Vácuo ; (2) Sistema de Gás de Troca ; (3) Sistema Pneumático ; (4) Criostato Óptico ; (5) Controlador de Temperatura

- 3) Sistema pneumático
- 4) Criostato óptico
- 5) Controlador de temperatura.

O conjunto de vácuo mecânico opera dinamicamente com 30μ e está em série com o do alto vácuo com bomba de difusão que opera dinamicamente com 2×10^{-6} torr. Ambos desempenham um papel importante no funcionamento de todo o sistema de baixa temperatura pois eles trabalham continuamente no decorrer dos experimentos, às vezes de 100 horas, mantendo o alto vácuo nas câmaras internas do criostato. O conjunto pneumático tem uma função auxiliar, pois ajusta a altura do eixo óptico do criostato com o eixo do espectrofotêmetro. O conjunto para gás de troca tem por finalidade servir como chave térmica possibilitando o contato térmico da amostra com o banho, pela introdução de gás He na câmara de troca ou a interrupção da condução térmica entre o banho frio e a amostra retirando-se o gás de troca e efetuendo-se vácuo mecânico ou alto vácuo dentro da câmara de troca. O conjunto para medidas ópticas à baixa temperatura tem como componente principal o criostato Janis que será descrito no item seguinte. Os conjuntos restantes também serão descritos nos itens a seguir.

III.2 - Criostato e Porta Amostra

Todas as medidas ópticas e tratamentos térmicos nas amostras foram realizados utilizando um criostato óptico modelo 8DT fabricado pela "Janis Research Company, Stonehan Mass". Ele foi projetado para operar com He e/ou N líquido, possuindo dois tanques cencentricos sendo que no mais externo, introduz-se N líquido e no mais interno He ou N líquido dependendo das condições experimentais. Nesse trabalho operou-se com nitrogênio líquido dentro dos tanques internos do criostato.

O criostato possui três acessos ópticos (dois alínhados) permitindo as geometrias paralela e perpendicular ao eixo óptico de medida (Figura 4), possibilitando ainda as trocas das janelas de acordo com o tipo de medida e da transparência requerida; na região do infravermelho (janela do KCI ou infrasil) na região do visível – ultravioleta (janela de safira ou suprasil). Em contato com o banho de He ou N líquido encontra-se uma ponta tubular de aço inox denominada câmara do gás de troca onde introduz-se gás He para efetuar o contato térmico entre o banho criostático e o porta amostra. No interior dessa câmara existem dois tubos concêntricos de cobre, soldados em extremidades opostas, sem haver con ato mecânico entre suas paredes mas que estão suficientemente pfoximas para facilitar a condutividade térmica quando o gás for introduzido.

Na extremidade oposta a do contato com o banho há um elemento resistor (4 W, 25 Ω) que é alimentado externamente por um Variac ou por um controlador de temperatura Modelo DTC-500 da "Lake Shore Cryotronics Inc.", quando for necessário aquecer a amostra controladamente. A temperatura na amostra pode ser variada lenta ou bruscamente de acordo com a tensão aplicada (2 ~ 10 volts) nos terminais do elemento resistor, combinada com uma mudança na pressão do gás de troca.

O porta amostra é constituído por um único bloco de cobre laminado na forma de "L" e preso por quatro parafusos na extremidade da câmara de troca por uma flange de cobre (Figura 4) que permite a rotação completa do porta amostra. Para melhorar o contato térmico entre o porta amostra e a extremidade da câmara de troca colocou-se folhas de índium entre as duas superfícies de contato. O porta amostra pode ser preso nessa extremidade de modo a satisfazer as condições de geometria paralela ou perpendicular (Figura 4).

III.3 -- Preparação das Amostras



Figura 4 – Câmara do Gás de Troca e Porta Amostra. (1) Entrada do Gás de Troca HE; (2) Banho de Nitrogênio ou Hélio L(quido; (3) Tubo Concêntrico; (4) Câmara do Gás de Troca; (5) Elemento Aquecedor; (6) Folhas de indium; (7) Termistor; (8) Termopar; (9) Máscara: (10) Amostra; (11) Bloco de Cobre. A – Geometria Paralela. B – Geometria Perpendicular

Os cristais de haletos alcalinos utilizados neste trabalho são todos ultrapuros com várias concentrações da impureza OH^- (~ $10^{1.7} OH^-/cm^3$), provenientes do "Crystal Growth Laboratory, University of Utah". As amostras foram clivadas no plano (1, 0, 0) com espessuras variando entre 0,7 mm e 1,02 mm de acordo com o caminho óptico desejado. A seguir a amostra é presa ao porta amostra por uma moldura comprimida por quatro parafusos com molas (Figura 4). Para medidas de transições eletrônicas no visível e ultravioleta a amostra é colocada de acordo com a geometria paralela mostrada na Figura 4. Já em medidas de transições vibracionais (no infravermelho) utiliza-se a geometria perpendicular para aumentar o caminho óptico. Para evitar o "by pass" dos raios de luz (luz espúria) o cristal foi mascarado com uma fita adesiva de alumínio).

III.4 - Medida e Controle de Temperatura

A medida da temperatura da amostra é efetuada utilizando-se um termopar de cobre-constantan com referência à 0°C, obtida utilizando-se o "Ice point reference" da "Kaye Instrumenta", ou gelo picado, fora do criostato. A ponta do termopar (junção entre os dois fios do termopar) foi isolada eletricamente por uma cola GE Varnish 7064 e presa no porta amostra por um parafuso. As extremidades opostas são conectadas com fios de cobre e colocadas num banho termostático à 0°C ou na referência é amplificada e registrada num graficador HP 7100 BM "Strip Chart Recorder". O valor da temperatura é obtido utilizando-se uma tabela tipo – T da "Omega Engineering Inc.". O erro na medida da temperatura é estimado em ± 1 K. O controle de temperatura acima de 77K foi efetuado manualmente, variando a tensão no resistor (que está em contato com o porta amostra) e a pressão do gás na câmara de troca, onde um equilíbrio (não estático) é atingido após ~ 30 min. A temperatura na amostra pode ser mantida com uma oscilação de ~ 8% em torno da temperatura desejada, com apenas pequenas alterações na tensão e pressão do gás.

Temperaturas abaixo de 77K foram atingidas solidificando o nitrogênio líquido contido no tanque mais interno do criostato. Para tal, introduz-se inicialmente uma pequena quantidade de nitrogênio líquido dentro do tanque interno e abaixa-se a pressão de vapor do banho bombeando sobre o nitrogênio líquido, conforme é mostrado na Figura 3. À medida que a pressão sobre o N líquido vai diminuindo a temperatura na amostra vai baixando lentamente até se estabilizar em torno de 52K (temperatura de nitrogênio sólido) após \sim 30 min. do início do bombeamento. A amostra pode permanecer aproximadamente umas 20 horas nessa temperatura durante esse regime dinâmico de bombeamento.

III.5 - Medidas de Absorção Óptica

O sistema utilizado (Figura 3) oferece grande versatilidade nas medidas de absorção óptica pois ele pode ser transportado facilmente de um espectrofotômetro para outro. Também pode-se facilmente igualar as alturas dos feixes ópticos do criostato com o do espectrofotômetro. Para medidas de absorção óptica no intervalo entre 4000 cm⁻¹ a 350 cm⁻¹ utilizou-se o "Perkin-Elmer Modelo 180 Spectrophotometer" com duplo feixe. Cuidados especiais tais como evitar a absorção óptica pelo vapor de água da atmosfera ao redor das janelas ópticas do criostato, introduzindo nitrogênio gasoso na região de medida, foram realizados para diminuir absorções indesejadas. Para medidas de absorção óptica no intervalo entre 4000 cm⁻¹ a 52000 cm⁻¹ utilizou-se o "Carl Zeiss DMR-21 Spectrophotometer" com prisma de quartzo monocromador M4Q III com duplo feixe (um para medida e o outro para referência). A resolução obtida com o "Carl Zeiss DMR-21" (M4Q III) foi em torno de 1 nm. A resolução obtida com o PE-180 variou de 0,6 a 5 cm⁻¹ de acordo com as exigências experimentais.

A determinação da concentração dos centros envolvidos nesse trabelho foi obtide usando-se a conhecida fórmula de Smakula:

$$N_f = Cte \frac{n}{(n^2 + 2)^2} K_{max} H$$
 (6)

onde:

- N = concentração de defeitos em cm⁻³
- f = intensidade de oscilador
- n = índice de refração do cristal no máximo da banda
- K = constante de absorção
- H = largura da banda na metade do seu máximo

A densidade óp::ca medida pelo espectrofotômetro está relacionada com a constante de absorção da seguinte maneira: O decréscimo da intensidade da luz ao atravessar a amostra é dada por;



onde d é a espessura do cristal. A densidade óptica (D.O.) é definida como D.O. = $\log \frac{I_o}{I}$ tal que a . constante de absorção seja:

$$K = \frac{2.303 (D.O)}{d}$$
(8)

III.6 - Métodos de Irradiação

Todos os processos de irradiações e iluminações descritos nesse trabalho foram realizados a baixas temperaturas com as amostras no criostato óptico. As amostras contendo (ons de impureza OH⁻ foram inicialmente submetidas a um processo de irradiação à 50 ou 77K com luz monocromática de comprimento de onda próximo ao máximo da absorção do OH⁻, na temperatura da irradiação. Como esses máximos de absorção estão na região do ultravioleta foi usado um conjunto "Bausch-Lomb" para irradiação, (Figura 5) com lâmpada ue Xenon de 150 watts proveniente da Hanovia 901C-11, fonte de alimentação para a lâmpada e um monocromador com grade de 2700 ranhuras/mil/metros # 33-86-01. A largura da banda passant: é ~ 20 nm. Em geral, espectros de ordem mais alta não foram eliminados. Em todos os processos de irradiação utilizando esse conjunto usou-se a fenda de entrada e de saída do monocromador com 6 mm.



Figura 5 - Diagrama Esquemático do Conjunto para Irradiação UV

14

Nos experimentos de fotodissociação do H_2O^- foi utilizado a geometria oferecida pelo espectrofotômetro "Carl Zeiss DMR-21" e sua fonte de luz monocromática. Para isso eliminou-se o feixe de referência (colocando-se em "single beam") do espectrofotômetro e abriu-se a fenda de entrada de luz no monocromador. Geralmente utilizou-se a fenda de entrada com 1 mm de largura e a fenda tipo S-5 na saída do feixe monocromático.

III.7 - Tratamento Térmico

Todos os tratamentos térmicos foram realizados com as amostras dentro do criostato cujo procedimento é o seguinte:

Retira-se o gás He da câmara de troca fazendo vácuo na mesma e aplica-se uma tensão constante (4 a 8 volts) nos terminais do elemento resistor, para o aquecimento da amostra. Dessa forma, consegue-se elevar a temperatura da amostra, inicialmente à 50K ou ⁷⁷K até 300K no máximo (dependendo da exigência experimental) com uma razão de aquecimento constante e reprodut(vel. Para esfriar a amostra, a tensão no elemento resistor é desligada e é introduzido gás He na câmara de troca provocando um decréscimo lento da temperatura na amostra, com queda exponencial. A seguir serão descritos dois tipos de procedimentos experimentais utilizados durante o tratamento térmico, com o fim de se obter maiores informações sobre a cinética de formação dos defeitos envolvidos.

1) Acompanhamento Dinâmico

Aqui, simultaneamente ao tratamento térmico, acompanha-se a subida da temperatura (na amostra) com um termopar (cobre-constantan) e a variação da densidade óptica para um comprimento de onda (de medida) fixo ou para o espectro todo em intervalos de tempo previamente estabelecidos. Essas cinéticas de mudança na absorção óptica da amostra durante seu tratamento térmico, são medidas utilizando ou o "Carl Zeiss" ou o PE-180, dependendo da região espectral de interesse. Dessa maneira tem-se uma correspondência entre o tempo e a temperatura (obtida pela curva registrada num graficador) obtendo-se portanto a densidade óptica versus temperatura, para um comprimento de onda fixo.

2) Tratamento Térmico Pulsado

Esse método foi utilizado nos estudos mais detalhados sobre os processos intermediários envolvidos na formação e destruição térmica de certos defeitos (por exemplo o H_2O^-). O método consiste em aplicarmos pulsos de temperatura alternados, onde a temperatura máxima atingida num certo pulso é sempre maior de que a do pulso imediatamente anterior, (Figura 6). Para a aplicação de um pulso de temperatura, faz-se vácuo na câmara de troca e aplica-se uma tensão (idêntica para todos os pulsos) nos tarminais do resistor, fazendo com que a temperatura na amostra cresça de maneira reprodutível (aproximadamente linear) até atingir um T_{max} onde desliga-se a tensão aplicada e introduz-se gás He na câmara de troca. A temperatura decresce exponencialmente até estabilizar-se em um mínimo que é igual para todos os pulsos. Após cada pulso de temperatura o espectro de absorção óptica (eletrônico ou vibracional) da amostra, na temperatura $T_{min'}$ é medido. Por fim, tem-se a densidade óptica de qualquar ponto do espectro em função de T_{max}

IV - RESULTADOS E CONCLUSÕES I

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos à pertir do estudo da cinética de formação e destruição dos vários defeitos produzidos (no intervalo de temperatura de 52K a 300K) utilizando a técnica de absorção óptica.



Figura 6 - Formato dos Pulsos de Temperatura, Utilizados nos Experimentos com Tratamento Térmico Pulsado

Como já foi mencionado no capítulo II, o fon substitucional OH⁻ nos haletos alcalinos dissocia-se sob irradiação UV à temperaturas abaixo de 200K. Para temperaturas abaixo ou da ordem de 100K, essa dissociação produz centros U₂(H^o_i) e O⁻, Figura 7, de acordo com a seguinte equação⁽¹⁷⁾:

$$OH^{-} + h\nu(OH^{-}) \xrightarrow{T \leq 100K} H^{0}_{i} + O^{-}$$
(9)

Nos diversos experimentos realizados neste trabalho, obteve-se conversões de OH⁻ em U₂ da ordem de 35% da concentração inicial do defeito OH⁻ ($\sim 10^{1.8}$ OH⁻/cm³). Essa conversão foi obtida submetendo-se as amostras à irradiações monocromáticas de comprimento de onda coincidente com o máximo da absorção eletrônica do OH⁻ à 77K, durante ~ 15 horas.

IV.1 - Comportamento Termodinâmico dos Produtos e Sub-Produtos do OH

A partir de uma certa concentração de defeitos U_2 , O⁻e OH⁻ obtida após a dossiciação do OH⁻, deversos defeitos intermediários e finais foram obtidos por ativação térmica do cristal, resultantes das diferentes associações e/ou reações dos defeitos iniciais. A seguir apresentar-se-á os resultados das diversas obervações experimentais dos vários sub-produtos obtidos em diferentes intervalos de temperatura, bem como a identificação de uma nova forma do defeito U₂, que foi denominado de U_{2x}, sendo este centro desconhecido até o presente.

Os centros U₂ produzidos nos diversos haletos alcalinos, conforme técnica já descrita, apresentam espectros de absorção eletrônica com "splittings" devido à interação spin órbita conforme mencionado na literatura⁽⁸⁾. Esses "splittings" são maiores para os cristais KBr e RbBr. A banda de absorção eletrônica do centro U₂ em KBr é mostrada na Figura 8.

Estudando o decaimento da densidade óptica no máximo da banda U_2 durante o tratamento térmico contínuo (por técnica já descrita no capítulo III) de um cristal de KCI:OH⁻ contendo centros U_2 , observou-se uma sequência de estágios como é mostrado na Figura 9. Esta sequência de estágios indica diferentes regiões de estabilidade térmica do centro U_2 ou diferentes configurações deste defeito a exemplo do que já foi observado em outros defeitos como o centro $U_1^{(9)}$. Verificou-se desta forma uma nova região de estabilidade para o centro U_2 , acima de 110K que é o valor de temperatura conhecido atualmente⁽³³⁾ quando a razão de destruição atinge valor máximo no KCI.

Uma análise cuidadosa da observação eletrônica dos centros U_2 resultante após o tratamento à 110K, indicou o aparecimento de uma nova banda em energia maior, à qual se denominou U_{2x} . No KBr as bandas de absorção eletrônica dos centros U_2 e U_{2x} apresentam-se mais resolvidas em energia do que no KCI, o que facilita a identificação e a distinção entre elas.

Para uma compreensão maior dos processos de formação dos defeitos e também a fim de eliminar os efeitos de temperatura nas bandas de absorção eletrônica (modificando as formas das bandas) durante o tratamento térmico, resolveu-se estudar detalhadamente a produção dos defeitos secundários por aplicações de pulsos de temperatura (tratamento térmico pulsado). Todos os pulsos de temperatura aplicados nesse tipo de experimento possuem formas semelhantes, variando-se apenas a temperatura máxima atingida. A forma dos pulsos sucessivos de temperatura utilizados nos experimentos com tratamento térmico pulsado é mostrada na Figura 10.

Foram realizados dois experimentos com tratamento térmico pulsado, um para o KCI:OH* e outro para o KBr: OH*. Os efeitos produzidos nas bandas de absorção eletrônica, medidos sempre na mesma temperatura de referência (T_{min}) após cada pulso de temperatura, são mostrados nas Figuras 11 e 12. Nessas duas figuras (11 e 12) pode-se observar, após as aplicações dos primeiros pulsos de



Figura 7 --- Espectros de Absorção Óptica na Região do UV, para uma Amostra de KCI: OH⁻, Mostrando e Fotodissociação do OH⁻. Essa Figura Mostra a Conversão de OH⁻ em Centros U₂ e O⁻, Após ~15 horas de Irradiação (a 77 K) com Luz de 202 nm.



Figura 8 - Espectro de Absorção Óptica do Centro U₂ em KCI e KBr. Nessa Figura são Mostrados os "Splittings" Devido à Interação Spin-Órbita. No KBr essa Interação Produz Três Bandas, U₂, U₂ e U₂"



Figura 3 – Destruição Lérmica dos Centros U₂ e Formação de Centros H₂O^{*} Observeda Durante Tratamento Térmico Contínuo de uma Amostra de KCI:OH^{*}. As Duas Curves Mostrades Nessa Figura Foram Obtidas em Experimentos Separados. A Medida de Densidade Óptica Durante o Tratamento Térmico foi Efetuada no Máximo da Banda Correspondente





Nessa Figura pode-se Observar que os Pulsos de Temperatura Utilizados nos Experimentos de "Pulse Annealing" Possuem forma Semelhante. Na Figura, T_{max} é a Temperatura Máxima Atingida no Pulso, e T_{min} a Temperatura de Referência (52K ou 77K) na qual se Efetua a Medida da Absorção Óptica. Nos Experimentos Realizados T_{max} Variou entre 52K e 300K



Figura 11 — Mudanças nos Espectros de Absorção Óptica Eletrônica por Pulso de Temperatura em KCI. Todos os Espectros Nessa Figura Foram Medidos a 77K Após cada Aplicação do Pulso. Nessa Figura Vemos a Formação de Centros H₂O⁻ e U_{2x} a Partir da Destruição Térmica dos U₂ e a Formação de Centros F e U com a Destruição Térmica dos Centros H₂O⁻



Figura 12 – Mudanças nos Espectros de Absorção Óptica Eletrônica em KBr por Aplicação de Pulsos de Temperatura. Todos os Espectros Apresentados Nessa Figura Foram Medidos a 52K Após cada Aplicação do Pulso. Essa Figura Mostra a Formação dos Centros H₂O⁻ a U_{2x} com a Destruição Térmica dos U_{2x} e a Formeção de Centros F a Partir da Destruição Térmica dos H₂O⁻

temperatura, o decaimento dos centros U₂ e a formação dos centros U_{2x} e H₂O⁻ e posteriormente, a destruição dos centros U_{2x} e formação de H₂O⁻. No final observa-se a destruição dos centros H₂O⁻ e a formação de centros F e U. Todos os processos de formação e destruição desses defeitos serão descritos e discutidos nos itens a seguir. Uma análise mais quantitativa bein como as equações envolvidas nesses processos serão dadas no item IV.1.5.

Na Figura 12 vê-se claramente a formação da banda U_{2x} . A posição do máximo dessa banda coincide com o máximo da banda U_2'' (componente da sub-estrutura da banda U_2 devido inte:ação spin-órbita). Nesta figura observa-se que no estágio de formação do centro U_{2x} a proporção entre o máximo da banda U_2 e o máximo da banda U_2'' não é mantida, ela diminui, indicando o crescimento de uma nova banda nessa região do espectro. Utilizando a proporção conhecida entre o máximo da banda U_2'' e comparando com a proporção medida nas mesmas posições do espectro, foi possível separar as bandas U_2''' e U_{2x} , uma vez que a proporção entre U_2 e U_2''' é mantida constante para diferentes concentrações de defeitos U_2 quando as medidas de absorção são efetuadas na mesma temperatura. A partir das Figuras 11 e 12 contruiu-se as Figuras 13 e 14 com a finalidade de identificar os vários estágios de estabilidade térmica dos defeitos e as origens dos vários defeitos secundários produzidos a partir dos centros U_2 , $O^-e OH^-$.

Essas duas figuras foram construídas fazendo-se um gráfico dos valores das densidades ópticas (obtidas das Figuras 11 e 12) nos máximos das bandas de absorção eletrônica dos centros U₂, U_{2x}, H₂O⁻ e F (medidas todas na mesma temperatura (52K ou 77K) após cada aplicação do pulso de temperatura) contra o valor da temperatura máxima (T_{max}) atingida no pulso. A Figura 13 (para o KCI) apresenta três regiões de estabilidade térmica (estágios) dos defeitos. No primeiro estágio (T \leq 120 K) há destruição térmica dos centros U₂ e formação de centros U_{2x} e H₂O⁻ no segundo estágio (120 K \leq T \leq 210 K) há destruição térmica dos centros H₂O⁻ são destruídos termicamente e são formados centros F. Já na Figura 14 (para o KBr) observa-se a formação de quatro regiões de estabilidade térmica dos centros U_{2x} e formação dos centros U_{2x} e H₂O⁻, no segundo estágio (110K \leq T \leq 110K) há destruição térmica dos centros U₂ e formação dos centros U_{2x} e H₂O⁻, no segundo estágio (110K \leq T \leq 180K) há um pequeno decaimento dos centros U_{2x} e formação de H₂O⁻, no quarto estágio (220K \leq T \leq 280 K) os centros H₂O⁻ são totalmente destruídos e são formados centros H₂O⁻, são totalmente e são formados centros U_{2x} e formação de H₂O⁻, no segundo estágio (120 K \leq T \leq 220K) os centros U_{2x} são destruídos totalmente e são formação de H₂O⁻, no segundo estágio (120 K \leq T \leq 280 K) os centros H₂O⁻ são totalmente destruídos e são formados centros F.

IV.1.1 - Energias de Ativação

As energias de ativação térmica para os vários estágios de formação e destruição térmica dos defeitos U_2 , U_{2x} , H_2O^- e F foram calculadas para os cristais de KCI e KBr utilizando-se os dados contidos nos gráficos das Figuras 13 e 14 e o seguinte procedimento:

Sabe-se que para um processo de primeira ordern a concentração inicial de defeitos varia exponencialmente com o tempo, numa temperatura T fixa, da seguinte forma:

$$N(t) = N_{o} e^{-\alpha t} \quad com \quad \alpha = \frac{1}{\tau} \quad e \quad \tau = \tau_{o} \quad e^{\frac{E}{K_{B}T}}$$
(10)

onde

N(t) = Concentração dependente de (para T fixo)

N_o = Concentração inicial de defeitos

 τ = tempo de relaxação (para uma temperatura T fixa)



Figura 13 — Estabilidade Térmica dos Produtos Primários e Secundários da Fotodissociação dos OH em KCI. Essa Figura Apresenta Três estágios: no Primeiro hé Formação de U_{2x} e H₃O Provenientes da Instabiblidade Térmica dos U₃; no Segundo há Formação de H₃O Provenientes da Destruição dos U_{2x} e no Terceiro Formação de Centros F a Partir da Destruição dos H₂O². T_{max} = Temperatura Máxima do Pulso



Figura 14 — Estabilidade Térmica dos Produtos Primários e Secundários de Fotodissociação do OHT em KBr. Essa Figura Apresenta Quatro estágios: no Primeiro há Formação de U_{2x} e H₂O Devido à Instabilidade Térmica dos Centros U₂, no Segundo e Terceiro há Formação de H₂O⁻ Proveniente da Destruição dos Centros U_{2x} e no Quarto há FOrmação de Centros F Provindos da Destruição dos H₂O⁻. T_{max} é a Temperatura Máxima do Pulso

- E = energia de ativação do processo
- K_R = constante de Boltzmann
- ✓ = temperatura em graus Kelvin (K)

t = intravalo de tempo correspondente ao tratamento isotérmico à temperatura T.

Obtém-se também que

$$N(t,T) = N_{o} \exp\left[\frac{-t}{\tau_{o}} \exp\left(\frac{-E}{K_{B}T}\right)\right]$$
(11)

Como a densidade óptica medida no máximo da banda de absorção do defeito é proporcional à concentração desses defeitos, (D.O. \propto N(t,T)), a expressão (11) transforma-se na seguinte forma:

$$D \cdot O_f = D \cdot O_i \exp\left[\frac{-t}{\tau_o} \exp\left(-\frac{E}{K_B T}\right)\right]$$
(12)

Onde:

D.O., é a densidade óptica inicial e fixa, medida no máximo da banda de absorção eletrônica do defeito e D.O., é a correspondente densidade óptica obtida após aplicação de cada pulso de temperatura. Aplicando o logarítmo neperiano nos quis membros da expressão (12) vem:

$$\ln \frac{D \cdot O_i}{D \cdot O_f} = \frac{t}{r_o} \exp\left(\frac{-E}{K_B T}\right)$$
(13)

Essa expressão é do tipo $Y = ae^{bx}$ (14) onde:

$$y = ln \frac{D \cdot O_i}{D \cdot O_f}$$
; $a = \frac{l}{r_o}$; $b = \frac{-E}{K_B}$; $x = \frac{1}{T}$

Como os pulsos de temepratura aplicados não são pulsos ideais (isotérmicos com mesma base de tempo para todos os pulsos) calcula-se uma temperatura efetiva $\{T_{ef}\}$ para cada pulso escolhendo-se arbitrariamente um valor constante para a base de tempo ⁽⁺⁾. Essa escolha é não arbitrária uma vez que a única informação que se deseja obter é o valor da energia de ativação, obtida a partir do valor de ϕ que é o coeficiente angular na expressão (14) quando linearizada.

Cálculo da temperatura efetiva. Nem toda a energia térmica (que é proporcional à temperatura) fornecida ao cristal durante a aplicação do pulso de temperatura é capaz de ativar termicamente o processo de destruição ou de formação de um defeito pois é necessária uma energia térmica mínima correspondente a uma temperatura mínima T₁ para iniciar a ativação de tal processo⁽⁺⁺⁾. Portanto, uma vez conhecido esperimentalmente o valor de T₁, calcula-se a área contida entre a curva do pulso e a reta horizontal passando por T₁. Com esse valor da área calcula-se um valor de temperatura (Δ T)^{*}, tal que

^(*) Base da tempo: 0,3 hrs para o experimento de tratamento tármico pulsado ne KCI e 0,4 hrs para o KBr.

^(**) Os valores de T₁ foram obtidos das Figuras 13 e 14.

multiplicado pela base de tempo escolhida dê a mesma área que a anterior, produzindo portanto efeitos aproximadamente idênticos sobre a concentração do defeito. Assim o valor da temperatura efetiva é dado por:

$$T_{ef} = T_1 + (\Delta T)^*$$



Utilizando-se os valores de T_{ef} calcula-se os valores de X correspondentes, $X = (T_{ef})^{-1}$. Os valores de Y, Y = In(D.O₁/D.O._f), correspondentes aos valores de X são calculados utilizando os dados contidos nas Figuras 13 (p/KCl) e 14 (p/KBr).

Finalmente ajustou-se os valores de Y e X de modo a obedecer o comportamento da curva (14), Y = ae^{bx}, pelo método dos mínimos quadrados (ver apêndice A). Dos ajustes obtém-se os parâmetros a, b e r². Os valores do coeficiente de determinação (r²) variaram entre 0,79 a 0,99. Do valor do parâmetro <u>b</u> obtém-se o valor da energia de ativação térmica usando-se: $E_{ativ} = -b K_B$ onde K_B é a constante de Boltzmann.

Os valores das energias de ativação de formação e destruição para os vários efeitos (secundários) nos diversos estágios das Figuras 13 e 14 foram calculados pelo método descrito acima e encontram-se relacionados nas Tabelas I e II.

	KCL:OH ⁻									
	Energia de Ativação Térmica (eV)									
		Formação		Destruição						
Def e ito	U _{2×}	H₂O⁻	F	U ₂	U _{2x}	H ₂ O ⁻				
Estágio I	0,057	0,059		0,072						
Estágio II		0,15			0,21					
Estágio III			0,63			0,76				

Tabela I

Ta	be	٦	I	I

			KBı	r:OH ⁻							
	Energia de Ativação Térmica (eV)										
		Formação			Destruição						
Defeito	U _{2×}	H ₂ O ⁻	F	U ₂	U _{2×}	H₂O ^ˆ					
Estágio I	0,030	0,040		0,096							
Estágio II		0,077			0,028						
Estágio III		0,17			0,30						
Estágio IV			0,32		<u> </u>	1,5					

IV.1.2 - Destruição do Centro U₂

Os centros U₂ produzidos pela fotodissociação dos centros OH⁻ tornam-se instáveis termicamente e decaem com razão máxima de destruição à ~ 110 K (Figura 13) e a ~ 100 K em KBr (Figura 14). Em consequência do desaparecimento dos centros U₂ observa-se a formação dos centros U_{2x} e H₂O⁻ (estágio I das Figuras 13 e 14). Também há recombinação de centros U₂ com seu anti-centro O⁻ produzindo moléculas de OH⁻ excitadas que se desexcitam por emissão luminescente observada também por Kőstlin⁽²⁰⁾.

Nas Figuras 11 e 12 pode-se ver a formação e destruição térmica dos centros U_{2x} . Em KCI à temperatura de 110K obtém-se a razão máxima de formação dos centros U_{2x} coincidente com a razão máxima de destruição dos centros U_3 (Figura 13) indicando que os centros U_{2x} são formados a partir dos centros U_2 termicamente destruídos. O mesmo processo ocorre no KBr (Figura 14) à temperatura de 100K. As estabilidades térmicas do centro U_{2x} para o KCI e KBr são diferentes sendo este mais estável do que no KCI. No KBr a estabilidade térmica desse defeito atinge até ~ 180 K e no KCI atinge até ~ 130K tornando-se termicamente instável à temperaturas acima destes valores, produzindo desta forma centros H_2 O⁻.

A seguir são relacionados os parâmetros característicos da banda de absorção eletrônica do centro U_{2x} obtidos experimentalmente para KCI e KBr.

	Parâmetros da Banda	a U _{2x} (medidos à 77K)
	Posição do Máximo (eV)	Largura à Meia Altura (eV)
KCI	5,58	
KBr	4,97	0,26
IV.1.3 - Formação + Destruição do Centro H2O⁻

Os rentros H₂O⁻ foram produzidos por tratamentos térmicos de amostras de KCI: OH contendo inicialmente centros U₂ obtidos no processo de fotodissociação parcial dos OH⁻'a baixa temperatura (77K), conforme mencionado no item anterior. Identificou-se esse defeito produzido com o defeito H₂O⁻ obtido por Rusch e Seidel^(32,33) pela igualdade dos espectros de absorção eletrônica de ambos os defeitos no cristal de KCI: OH⁻. Com a finalidade de acompanhar a cinética de produção de H₂O⁻, utilizou-se duas técnicas de tratamento térmico: tratamento contínuo ou pulsado, conforme foi mencionado nos items anteriores. O resultado do acompanhamento do crescimento do máximo da banda de absorção eletrônica (técnica já descrita no capítulo III) do centro H₂O⁻ durante o tratamento contínuo, Figura 9, mostrou a existência de dois estágios de formação desse defeito. Esses estágios são melhor identificados nos resultados dos experimentos com tratamento térmico pulsado ("pulse annealing"); estágio 1 (100 \leq T \leq 120K), estágio II (120 \leq T \leq 210K), Figura 13. A construção dessas figuras foi discutida no início da seção IV.1. As razões máximas de formação de U_{2x} e de H₂O⁻ no primeiro estágio de ambas as figuras coincidem com as razões máximas de destruição dos centros U₂, Essas razões máximas ocorrem a 110 K cm KCI e a 100 K em KBr.

Os centros U_{2x} são termicamente mais estáveis no KBr do que no KCI devido a energia de ativação de destruição térmica do centro U_{2x} ser maior no KBr (0,30 eV) do que no KCI (0,21 eV). Isso é também confirmado pelo fato do espaço disponivel no interstício⁽⁺⁾ ser maior no KBr (onde d=3,3 Å) do que no KCI (d=3,14 Å) sendo portanto necessária maior energia térmica oferecida pelos fonons da rede de KBr do que no KCI para que o (on intersticiul H^O₁ migre. Esse é o fator responsável pela formação do extenso patamar (100K $\leq T \leq 180$ K) de estabilidade térmica do centro U_{2x} observado na Figura 14. Consequentemente, surge um novo estágio de formação de H₂O⁻ em KBr (estágio II da Figura 14) que apresenta portanto três estágios no total: estágio I (90 $\leq T \leq 110$ K), estágio II (110K $\leq T \leq 180$ K) e estágio III (180 $\leq T \leq 220$ K). Observa-se também que no último estágio de formação de H₂O⁻ são coincidentes indicando que nesse estágio os centros H₂O⁻ são produzidos a partir da destruição térmica dos centros U_{2x}. Essas razões máximas ocorrem à T ~ 150 K em KCI e a T ~ 205 K em KBr. Das Figuras 13 e 14 vêse que os centros H₂O⁻ tornam-se instáveis termicamente à temperaturas acima de 210K e que as razões máximas de destruição são atingidas em T ~ 235 K em KCI e T ~ 245 K em KBr.

IV.1.4 - Formação de Centros F e U e Reconstituição do OH⁻

Nas Figuras 13 e 14 observa-se a formação de centros F nos seguintes intervalos de temperatura: $210 \leq T \leq 280$ K em KCI e 220 K $\leq T \leq 280$ K em KBr. As razões máximas de formação de F, tanto em KCI como em KBr, são coincidentes com a razão máxima de destruição de H₂O⁻ indicando que os centros F são produzidos a partir da destruição térmica dos centros H₂O⁻.

Comparando as densidades ópticas no máximo da banda de absorção eletrônica dos centros F, atingida nesse processo (Figuras 13 e 14), notou-se que maior número de centros F são formados no KBr do que no KCI, pois as intensidades de oscilador do centro F são aproximadamente iguais ($f \sim 0.8$) nessas duas redes. Observou-se também a formação preferencial de centros U⁽⁺⁺⁾ a partir da destruição térmica dos centros H₂O⁻ no KCI. Os centros U possuem uma banda de absorção eletrônica na região da banda de absorção eletrônica do OH⁻ de maneira que se observara soma dessas duas bandas, produzíndo uma distorção aparente nessa região do espectro, como pode ser visto na Figura 11.

Após a produção de centros F, observa-se o decaimento destes e dos centros U e a formação de moléculas de OH⁻ após alguns dias/semanas de permanência da amostra na temperatura ambiente. Nas

^(*) Para uma rede do tipo NaCI o interstício tem um diâmetro estimado em 0,73 d onde d é o perêmetro da rede.

^(**) O centro U é constituído por um (on de hidrogênio H° ocupando uma vacância de cloro, H°

amostras que foram submetidas a tratamentos térmicos pulsados e posteriormente deixadas por longo tempo (alguns meses) à temperatura ambiente e protegidas da luz, observou-se um desaparecimento total dus centros F e U e uma recuperação de 90 a 95% dos OH⁻ fotodestruídos inicialmente. Na Figura 15 é mostrado o desaparecimento dos centros F e U e a formação de centros OH⁻ para uma amostra de KBr anteriormente submetida a tratamentos térmicos pulsados.

IV.1.5 - Mecanismos e Modelos

Com base nas observações experimentais já mencionadas nos itens anteriores, com respeito ao comportamento termodinâmico dos produtos primários e secundários da fotodissociação do OH⁻, e com o apoio de algumas medidas de concentrações dos defeitos, serão propostos vários mecanismos envolvidos nas diversas regiões de estabilidade térmica dos defeitos mencionados anteriormente. Em todas as medidas quantitativas do número de defeitos produzidos utilizou-se o método da pesagem que consiste em calcular a concentração do defeito utilizando a fórmula de Smákula (6) e a área sob a banda (em D.O. x eV). Também foram utilizados os seguintes valores das intensidades de osciladores para as bandas $U_{2x} = H_2O^-$ em KBr: $f_{U_{2x}} = 0.35 e f_{H_2O}^- = 0.62$. O método de calculo destes valores de f será mostrado no capítulo V. A seguir será apresentada uma análise mais quantitativa da destruição dos centros U_2 e formação dos centros $U_{2x} = H_2O^-$ para o KBr umav ez que neste cristal a banda U_{2x} está mais resolvida e consequentemente distinta da banda U_2 .

IV.1.5.1 - Estágio I em KBr

Utilizando-se os espectros 3 ($T_{max} = 90K$) e 5 ($T_{max} = 110K$) da Figura 12, calculou-se as áreas (em D.O. x eV) sob as bandas U₂, U_{2x} e H₂O^{*}, pelo método da pesagem. A área está relacionada com a concentracão de defeitos através da seguinte fórmula:

$$N = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right] \frac{\text{Årea (em D. O x ev)}}{f}$$
(15)

onde

N é a constante de defeitos

- C é uma constante de proporcionalidade
- n é o índice de refração no máximo da banda
- f é a intensidade de oscilador da transição

Os seguintes valores dos parâmetros n e f e das áreas obtidas são tabelados abeixo:

Tabela III

Banda	n	f	Área (em D.O x eV)
U ₁	1,604	0,41ª	0,684
U _{2x}	1,604	0,35	0,202
H₂O″	1,496	9,62	0,069

a 😁 obtido da referência (33)



Figura 15 — Reconstituição dos OH Fotodestruídos em KBr. Nessa Figura Pode-se Observar o Decaimento dos Centros F e U e a Recuperação dos Centros OH⁻, Durante um Longo Período de Permanência da Amostra a 300K (no escuro) Após ter Sido Submetida Inicialmente a um Processo de Fotodissociação de OH⁻ e Posteriormente a Vários Tratamentos Térmicos Pulsados. A Linha em Tracejado é o Espectro Inicial da Amostra, Antes de ser Irradiada com UV

Substituindo-se os valores tabelados (Tabela III), para os vários defeitos, na relação (15) obtern-seque: $N_{U_2} = 1,02.10^{-1} \text{ C}; N_{U_{2x}} = 3,5.10^{-2} \text{ C} e N_{H_2O}^{-} = 7,5.10^{-3} \text{ C}.$ Após uma análise cuidadosa da banda OH⁻, constatou-se que a mesma parmaneceu praticamente constante com a destruição térmica dos centros U₂ durante o tratamento térmico até 110K. A banda O⁻ diminuiu, indicando que uma certa quantidade de centros C⁻ foram consumidos nesse processo. Como se supõe que o centro U_{2x} é formado a partir de um único centro U₂ termicamente instável (conforme modelo proposto a seguir para o centro U_{2x}) e que o centro H₂O⁻ é formado por um H⁰₀ e um OH^{-(37,38)}, portanto esses dois defeitos consomem três halogênios uma vez que a banda de absorção dos centros OH⁻ permaræce constante. Portanto o número de átomos de hidrogênio inicialmente instáveis que se encontram associados em novos defeitos após tratamento térmico à 110K é dado por:

$$N = N_{U_{2x}} + 2N_{H_2O} = 5.04 \cdot 10^{-2}C$$

Comparando com a concentração inicial de centros U_2 , anteriormente calculada, conclui-se que faltam aproximadamente 50% dos átomos de hidrogênios iniciais (centros U_2), e que apenas 50% dão origem aos defeitos OH⁻, U_{2x} e H_2O^- , produzindo 8% de centros OH⁻, 34% de centros U_{2x} e 8% de centros H_2O^- , nesse primeiro estágio de formação. Portanto 50% dos centros U_2 termicamente instâveis, no KBr, desaparecem não produzindo banda de absorção eletrônica observável mas produzindo pro vavelmente moléculas de hidrogênio intersticiais que não possuem transições eletrônicas ou vibracionais ativas no infravermelho.

Com base nesses resultados propõem-se as seguintes reações para o estágio 1:

$$100 \text{ H}_{i}^{0} + \text{ KT}(\text{T} \sim 110\text{K})$$

$$50 \text{ H}_{i}^{0} (\text{desaparecem}) \qquad \text{h}\nu(\text{OH}^{-})$$

$$8 \text{ H}_{i}^{0} + 8 \text{ O}^{-} \rightarrow 8 \text{ (OH}^{-})$$

$$60 \text{ H}^{0} \rightarrow 8 \text{ OH}^{-} \qquad (16)$$

$$\begin{array}{c} & & \\ & &$$

$$\frac{1}{34} H_{i}^{o} + 34 \text{ [OH}^{-} \rightarrow 34 \text{ [H}_{i}^{o} \text{ . OH}^{-} \text{]}$$
(18)

A equação (16) está de acordo com a proposta por Kőstlin⁽²⁸⁾ e a equação (17) de acordo com a proposta por Rusch e Scidel^(37,38). Somando as equações (16) e (17) obtém-se uma equação para a formação de H₂O⁻ envolvendo 2 centros U₂ e um O⁻, como segue:

$$2 H_i^0 + \boxed{O^-} \longrightarrow \boxed{H_2 O^-} + h\nu(OH^-)$$
(19)

A equação (18) propõe que o centro $U_{2\pi}$ seja constituído por um átomo de hidrogênio neutro, intersticial, aprisionado e estabilizado termicamente por um centro OH⁻. Essa interação entre os dois defeitos é tal que o centro OH⁻ embora participante dessa nova configuração, continua com sua transição na região da banda OH⁻ de forma idêntica à de um centro OH⁻ normal. Não se observou parturhação nessa transição que se manifestasse através de mudança na meia largura ou na posição de

máximo da banda OH⁻. Entretanto observa-se uma nova banda de absorção na região da banda U₂, a banda U₂, que é atribuída à uma absorção eletrônica semelhante à absorcão do centro U₂ mas deslocada para energia maior devido à interação com o defeito OH⁻. Us fatores essenciais que levaram à essa conclusão foram :

- O defeito U_{2x} deve ser formado essencialmente por um átomo de hidrogênio, pois sabe-se que ele surge com o desaparecimento do centro U₂, Figuras 13 e 14, interagindo ou com seu anti-centro O⁻ ou com o fon OH⁻, que são os únicos defeitos inicialmente presentes, sendo que a possibilidade de interação com seu anti-centro é eliminada pelo mecanismo de recombinação.
- 2) Centros H₂O⁻ são formados a partir da destruição térmica dos œntros U_{2x}.
- 3) As razões máximas de formação dos centros H_2O^- e de destruição dos centros U_{2x} coincidem (em T ~ 205K).

Portanto conclui-se que o centro U_{2x} possui uma configuração intermediária na formação de efeito H_2O^- . A observação experimental de suas regiões de estabilidade do defeito U_{2x} no KBr (estágios II e III da Figura 14), com energias de ativação de destruição $E_{11} = 0,03 \text{ eV}$ e $E_{111} = 0,3 \text{ eV}$ indica que o átomo de hidrogênio intersticial está ligado em um dos dois poços de potenciais perto do OH⁻, conforme esquema abaixo:



onde

- 1) Poço de potencial (esquemático) representando uma posição intersticial da rede em KBr.
- 2) Poço de potencial (esquemático) representando uma posição substitucional da rede.

A seguir serão apresentados alguns resultados de medidas quantitativas dos números de defeitos destruídos e produzidos no estágio III para o KBr (Figura 14).

IV.1.5.2 - Estágio III no KBr

Conforme já mencionado, nesse estágio observa-se a produção de centros H_2O^- à partir da destruição térmica dos centros U_{2x} . Uma análise cuidadosa da banda de absorção na região da banda OH⁻⁻ resultante após a destruição total dos centros U_{2x} (espectro 7 da Figura 12) revelou a formação de centros U, deslocando o máximo de absorção nessa região para energia mais baixa (deslocamento de 700 cm⁻¹).

Com a findalidade de se obter a razão entre as concentrações de centros U e H_2O^- produzidas com a destruição térmica dos centros U_{2x} , utilizou-se o método de pesagem (ja mencionado) para c cálculo das áreas correspondentes aos incrementos e decréscimos das bandas U_{2x} , H_2O^- e U + OH⁻ entre os espectros 6 e 7 da Figura 12. Os valores calculados para essas áreas e os valores dos parâmetros empregados nos cálculos das concentrações utilizando a expressão 15, encontram-se relacionados na Tabela IV.

Com a destruição de uma quantidade $N_{U_{2x}}$ de centros U_{2x} sabe-se que são consumidos N_{OH^-} (Centros OH⁻) e produzidos $N_{H_2O^-}$ e N_U (centros H_2O^- e centros U respectivamente). Com base nas observações experimentais na formação desses defeitos a partir da destruição dos U_{2x} e com apoio do modelo proposto anteriormente para o defeito U_{2x} , pode-se parcialmente concluir que com a ativação térmica, o átomo de hidrogênio aprisionado pelo fon OH⁻ migra (dessa posição) em direção à vazância contendo o fon OH⁻. Este pode ser capturado pelo fon OH⁻ produzindo diretamente o centro H_2O^- ou capturar o elétron deste fon trocando de posição com o fon em si localizando-se dentro da vacância (centro U), deslocando-se a molécula OH^o para a posição intersticial. Essas moléculas OH^o₁ não produzem bandas de absorção eletrônica. Portanto pode-se concluir que a destruição de um centro U_{2x} leva à destruição de um centro OH⁻. Isso implica que $N_{OH^-} = N_{U_{2x}}$. Sabe-se também que $N_{H_2O^-} + N_U = N_{U_{2x}}$.

Banda (em KBr)	n	f	Área α Peso (″) (gramas)
U _{2x}	1,604	-	0,1312 g
H₂O⁻	1,496	0,62	0,1025 g
U	1,645	0,83 ^(a)	
он-	1,645	0,13 ^(b)	
U+OH ⁻	1,645		0,0830 g

Tabela IV

(a) obtido da referência (37)

(b) obtido da referência (23)

Levando-se em conta os fatores acima obtém-se que a intensidade de absorção provocada pela formação de centros U e destruição de centros OH⁻, proporcional ao aumento de área (ou peso) na região da banda (U + OH⁻) é dada por:

^(*) Utilizou-se papel vegetal com densidade constante e como as medidas são relativas, usou-se diretamente o paso do papel, pois este é proporcional à área.

$$N_U f_U - N_{OH^-} f_{OH^-} = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_U$$
. Peso (U + OH⁻) (20)

Também as intensidades de absorção das bandas U_{2x} (destru.da) e H_2O^- (produzida) podem ser escritas como segue:

$$N_{U_{2x}} f_{U_{2x}} = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_{U_{2x}} Peso(U_{2x})$$
(21)

$$N_{H_2O} - f_{H_2O}^- = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_{H_2O}^-$$
 (22)

Dividindo (20) por (21) e (22) por (21) obtém-se duas relações:

$$\frac{N_{U}f_{U}-N_{OH}-f_{OH}}{N_{U_{2x}}f_{U_{2x}}} = \left[\frac{n}{(n^{2}+2)^{2}}\right]_{U} \cdot \left[\frac{(n^{2}+2)^{2}}{n}\right]_{U_{2x}} \frac{Peso(U+OH^{-})}{Peso(U_{2x})} = A \quad (23)$$

$$\frac{N_{H_2O} - f_{H_2O}}{N_{U_{2x}} f_{U_{2x}}} = \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2}\right]_{H_2O} \cdot \left[\frac{(n^2 + 2)^2}{n}\right]_{U_{2x}} \cdot \frac{Peso(H_2O)}{Peso(U_{2x})} = B$$
(24)

Fazendo $N_{OH}^{-} = N_{U_{2X}}^{-} = 1 \Rightarrow N_{H_2O}^{-} + N_U^{-} = 1$ e substituindo-se em (23) e (24) e isolando N_U^{-} a partir dessas duas equações obtém-se finalmente:

$$N_{U} = \frac{A f_{H_2O^-} + B f_{OH^-}}{A f_{H_2O^-} + B f_{U}}$$
(25)

Calculando-se os valores de A e B utilizando-se os valores da Tabela IV e substituindo em (25) obtém-se que $N_{ij} = 0.45$ e $N_{H_2O}^{-=} 0.55$. Esse resultado mostra que para cada 100 U_{2x} destruitos são formados 45 centros U e 55 centros H₂O⁻. Com base nesses resultados propõe-se a seguinte equação para a destruição térmica dos centros U_{2x} (em KBr):

$$2 [H_{i}^{0} \cdot OH^{-}] + KT(T \sim 200K) - 1 H^{-} + 1(OH^{*})_{i}$$
(26)

Esse mecanismo propõe que a formação de H_2O^- e de U a partir da destruição térmica dos U_{2x} , são igualmente prováveis (em KBr). Isso mostra que energeticamente a configuração de centro H_2O^- e a ce centro U mais OH_i^o são equivalentes, permitindo parcialmente concluir que a configuração do centro H_2O^- possui um átomo de hidrogênio fracamente ligado ao OH^- . O modelo para o centro H_2O^- será discutido no final do capítulo V, sendo este um dos argumentos utilizados em favor da configuração proposta.

Utilizando o resultado apresentado na equação (26) onde $\frac{N_{H_2O^-}}{N_U} = 1$, e substituindo na

equação (24) obtém-se o valor relativo entre as intensidades de osciladores das bandas U_{2x} e H₂O⁻: $f_{U_{2x}} = 0,56 f_{H_2O^-}$, usando o valor 0,62 para $f_{H_2O^-}$ (estimado a seguir, para a banda H₂O⁻ em KBr) obtém-se que $f_{U_{2x}} = 0,35$ (KBr).

IV.1.5.3 - Estágios III (KCI) e IV (KBr)

Com base nos resultados apresentados no item IV.1.4 é proposta a seguinte equação para a destruição térmica dos centros H₂O⁻ tanto em KCI como em KBr:

$$t H_2O^- + KT(T \sim 240K) + V[H^- + OH_i^o]$$

$$z [OH^- + H_i^o (instaivel)]$$
(27)

onde os números t, x, y, z que satisfazem a relação t = x + y + z, serão determinados a seguir.

Utilizando-se o método da pesagem, calculou-se a área sob a banda H_2O^- (em KCI) da Figura 11 (espectro 7 ($T_{max} = 205$ K)) e as áreas correspondentes à formação da banda F e ao incremento da absorção na região da banda OH⁻ obtidas após o tratamento até T = 285K (espectro 9 da Figura 11). Os valores calculados para essas áreas e os valores dos parâmetros utilizados nos cálculos das concentrações utilizando a expressão (15), encontram-se abaixo relacionados (Tabela V):

Tabela	v
--------	---

Banda (em KCI)	n	f	Áres (em D.O x eV)
H ₂ O ⁻	1,496	0,623	0,274
F	1,496	0,74 ^(a)	0,0476
U	1,645	0,7 ^(b)	
ОН	1, 64 5	0,13	
U+OH-	1, 64 5	. _	0,215

(a) obtido da referência (23)

(b) obtido da referência (26)

Utilizando e expressão (15) para o cálculo das concentrações vem:

$$N_i = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_i \cdot \frac{\text{Area (i)}}{f_i}$$
 onde $i = H_2 O^-$, F (28)

$$N_U f_U + N_{OH^-} f_{OH^-} = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_{U+OH^-} + Area(U+OH^-)$$
 (29)

Substituindo os valores da Tabela V nas equações (28), (29) e usando a relação N_{H 2}O⁻ = N_F + N_U + N_{OH}-, obtém-se os seguintes valores:

$$N_{H_2O^-} = 0,0366C; N_F = 0,0054C; N_U = 0,0208C; N_{OH^-} = 0,0104C$$

onde

C é uma constante. É formado portanto, 57% de centros U, 15% de centros F e 28% de centros OH⁻ com a destruição de 100% de centros H_2O^- . Com esses resultados os valores encontrados para t, x, y, z são respectivamente: 7, 1, 4, 2. Desta forma a equação 27 para a destruição de centros H_2O^- em KCI fica:

7
$$H_2O^-$$
 +KT(T ~ 235) \rightarrow 4 H^- + 1 e + 2 OH^- + 3 H_i^o (móvel) + 5(OH_i^o) (30)

O centro H_i^o produzido não recombina diretamente com o centro O⁻ mas é estabilizado em alguma forma não identificável. O fato de não se conhecer certamente a estrutura do centro O⁻ dá margem a várias interpretações quanto à estabilização do H_i^o (móvel) mencionado na equação (27). Uma delas é a seguinte: o H_i^o (móvel) é capturado pelo (on O⁻ intersticial produzindo OH_i⁻⁺ se o centro O⁻, puder ter uma configuração do tipo O⁻ + além da suposta configuração O⁻.

Observando-se o espectro 9 da Figura 12 após a destruição dos centros H_2O^- e a produção de centros F no KBr, nota-se que a produção de centros U e OH⁻ é desprezível em relação à produção de F. Medindo-se a área inicial sob a banda H_2O^- da Figura 12 (espectro 8 ($T_{max} = 225$ K)) e a área sob a banda F da Figura 12 (espectro 9 ($T_{max} = 280$ K)) e utilizando-se o método da pesagem obteve-se os seguintes valores:

Área (H₂O⁻) \propto Pêso (H₂O⁻) = 0,2313 g ; Área (F) \propto Peso (H₂ \sim 0.2984 g

Com o emprego da expressão (15) pode-se relacionar as duas intensidades de absorção como seguer

$$\frac{N_{F} f_{F}}{N_{H_{2}O} - f_{H_{2}O}} = \frac{P\hat{e}so(F)}{P\hat{e}so(H_{2}O^{-})} = \frac{0,2984}{0,2313}$$

Usando o fato que $N_F \approx N_{H_2O}^-$ obtém-se que $f_{H_2O}^- = \frac{f_F}{1,29}$. Substituindo o valor de $f_F = 0,80$ encontrado na literatura deduz-se que $f_{H_2O}^-$ (em KBr) $\simeq 0,62$.

Com base nessas observações propõe-se a seguinte equação para a destruição térmica de centros H2O⁻ em KBr:

$$1 \left[H_2 O^{-} \right] + KT(T \sim 245 \text{ K}) \longrightarrow 1 \left[e \right] + 1 H_i^o (capturado) + 1(OH_i^o)$$
(31)

As equações (30) e (31) propostas para a destruição térmica dos centros H₂O⁻ não concordam com a proposta por Rusch e Seidel^(37,38) que propuseram a formação de centro F e molécula de água intersticial, pelos seguintes argumentos:

- Foram efictuadas várias medidas de absorção na região do infravermelho em amostras de KCI e KBr após total destruição dos centros H₂O⁻, consequentemente nenhuma banda de absorção que pudesse ser atribuída à uma das transições vibracionais da molécula de água (intersticial) foi detetada.
- 2) A produção de centros U observada durante a destruição do centro H₂O⁻ permite concluir que não há moléculas de água intersticiais estáveis pois um hidrogênio encontra-se dentro da vacância.
- 3) A recuperação de 90% dos centros OH⁻ inicialmente destruídos, após a destruição dos centros H₂O⁻ também não favorece a produção de moléculas de água (estáveis) intersticiais, pois se as mesmas fossem produzidas haveria menos hidrogênios candidatos à recuperação dos centros OH⁻.
- A seguir serão discutidos alguns mecanismos envolvidos na reconstituição dos OH⁻ 'a 300 K.

IV.1.5.4 - Reconstituição dos Centros OH-

Como já foi mencionado anticriormente, observa-se após a permanéncia da amostra (KCI e KBr) durante algumas semanas no escuro e a 300K, (e após a produção de centros F e U), o desaparecimento total destes centros e uma recuperação da ordem de 90% a 95% dos centros OH⁻ que foram inicialmente destruídos. Tendo em vista os mecanismos propostos para a destruição dos H₂O⁻, conclui-se que à 300K as moléculas OH⁰ intersticiais produzidas a T ~ 240K são ativadas termicamente reagindo com os centros F produzindo (ons OH⁻. Os argumentos acima discutidos indicam ser este o mecanismo mais provável responsável pelo desaparecimento dos centros F.

De certa forma esse mecanismo proposto é semelhante ao observado por Morato⁽²⁶⁾ na interação entre centros F e U₂ onde constata-se que: Para T < 200K o átomo de hidrogênio móvel (H_i^o) ao aproximar-se de um centro F (\boxed{e}), ao invés desse hidrogênio ser capturado pela vacência produzindo centro U ($\boxed{H_i^o}$), o elétron do centro F tunela da vacência para o interstício produzindo o centro U₁ (H_i^-) deixando a vacência desprovida do elétron.

$$H_i^o + e + KT (T < 200K) \rightarrow H_i^- + e$$

Só após elevar-se a temperatura acima de 200K é que o fon H^{*} é termicamente ativado e eventualmente capturado uela vacância formando centro U seguido da reação:

$$H_i^- + H_i^- + KT (T > 200 K) \rightarrow H_i^-$$

O desaparecimento dos centros U é explicado como uma convequência da reação entre ele e una molecula OH¹ ativada termicamente produzindo um centro OH1 e um áto mo de hidrogênio, H⁰_i, móvel. Este atomo de hidrogênio môvel recombina se a seguir com um centro O1 sem emissão de luz pois a eficiência quântica de emissão nesse processo é nula nessa região de temperatura (T ~ 300 K) conforme mostrou Kőstlin⁽²⁰⁾, produzindo um centro OH1.

Para que haja uma quase total recuperação dos ions OH ; 70% dos hidrogenios desaparecidos no início do processo térmico (Estágio I) devem reagin com os centros O ; produzindo centros OH⁺. Esse mecanismo entretanto, não foi identificado, uma vez que inão sabemos qual é a configuração em que se encontram esses átomos de hidrogênio desaparecidos.

Com base nessa discussão propõem-se as seguintes reacões, que são os mecanismos mais prováveis envolvidos no desaparecimento dos centros F e U e reconstituição dos OH⁻:



V - RESULTADOS E CONCLUSÕES II

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos com o estudo das propriedades intrínsecas do defeito H_2O^- : transições vibracionais e efeito isotópico, variações das transições eletrônicas com a temperatura e fotodissociação. Baseando-se em novas propriedades do centro H_2O^- que foram observadas e de alguns mecanismos verificados com a dissociação térmica ou óptica desse defeito, é apresentada uma crítica ao modelo originalmente proposto por Rusch e Seidel sugerindo-se um novo modelo estrutural para esse defeito.

V.1 - Generalidades

O centro H₂O⁻ foi produzido em vários outros haletos alcalinos (KBr, RbCl, RbBr) por tácnica análoga à utilizada em KCl. Os espectros de absorção óptica eletrônica do H₂O⁻, nesses cristais, localizam-se todos na região de banda F, comforme é mostrado na Figura 16.

Utilizando-se a posição do máximo (λ_{max}) das diversas bandas da Figura 16 e o parâmetro de rede (d) correspondente, fez-se um gráfico dos valores de $\log(\lambda_{max})$ em função de log (d) como é mostrado na Figura 17. Obteve-se uma reta indicando que o máximo da banda de absorção eletrônica do centro H₂O⁻ obedece à relação de Molwo Ivey ($\lambda_{max} = ad^b$). Ajustando-se os quatro pontos experimentais à uma curva do tipo acima pelo método dos mínimos quadrados obteve-se os seguintes parâmetros do ajuste: a = 163,64 e b = 3,04, (com fator r² = 0,97).



Figura 16 - Banda de Absorção Eletrônica (a 52K) de Centros H₂O^{*} para Vários Haletos Alcalinos



Figura 17 -- Posição do Máximo da Banda H₂O⁻ (λ max), a 77K, em Função do Parâmetro de Rede (d), para Quatro Haletos Alcalinos

Das medidas de absorção óptica na região do infravermelho em KCI: QH⁻, contendo centros H_2O^- , detetou-se uma banda de absorção (sem estrutura) localizada em 1410 cm⁻¹ (a 77K) que foi atribuída à uma transição vibracional (localizada) do centro H_2O^- . O teste definitivo que levou à essa conclusão foi baseado na propriedade de fotodissociação do centro H_2O^- que será descutida na seção V.3. Por ora basta mencionar que o centro H_2O^- se fotodissocia completamente quando absorve luz na região da sua banda de absorção eletrônica. Desta forma, iluminou-se a amostra de KCI contendo centros H_2O^- , durante ~ 2 horas com: luz monocromática de comprimento de onda coincidente com o máximo da banda de absorção principal do centro H_2O^- , sendo efetuada em seguida a medida de absorção no infravermelho. Observou-se dessa medida, que a banda localizada em 1410 cm⁻¹ anteriormente detetada, desapareceu com a fotodestruição dos centros H_2O^- . A seguir efetuou-se novo tratamento após o resfriamento até 77K, nova medida do espectro na região do infravermelho, sendo detetada novamente a banda de absorção localizada em 1410 cm⁻¹. Obteve-se desta forma uma correlação segura entre a transição IR observada e a banda H_2O^- . Devido a esta propriedade de fotodissociação do H_2O^- pode-se confirmar que a banda de absorção em 1410 cm⁻¹ é provocada por uma transição vibracional do centro H_2O^- , ativa no infravermelho.

Um outro teste foi efetuado para se confirmar a presença de hidrogênio no defeito: o do efeito isotópico. Para tal utilizou-se uma amostra de KCI: QD⁻ contendo centros D₂O⁻ produzidos da mesma forma que o H₂O⁻. Da medida do espectro de absorção na região do infravermelho detetou-se uma banda de absorção (sem estrutura) localizada em 1050 cm⁻¹ à 77K. Finalmente efetuou-se o teste da fotodissociação (mencionado acima), confirmando ser essa banda devida à uma transição vibracional do centro D₂O⁻. Essas duas bandas são mostradas na Figura 18 para as temperaturas de 52K e 77K, mostrando-se o efeito isotópico e o afinamento da banda com o decréscimo da temperatura. O efeito isotópico observado produz um deslocamento do máximo da banda para energia mais baixa por um fator igual a $\frac{W(H_2O^-)}{W(D_1O^-)} = 1,343$. Esse fator está bem próximo (desvio de 5%) do valor $\sqrt{2}$ obtido para um

oscilador harmônico simples quando substitui-se a massa <u>m</u> por <u>2m</u>. O resultado anterior mostra que esse oscilador comporta-se aproximadamente como um oscilador simples (um proton isolado) quanto ao efeito isotópico.

V.2 - Absorção Óptica Principal do Centro H₂O⁻ em KCl

A banda de absorção (principal) eletrônica do centro H_2O^- apresenta uma estrutura composta por pelo menos quatro bandas gaussianas. A fim de obter-se essas bandas, utilizou-se um programa de computador (Apêndice B) que ajusta o espectro estruturado por uma soma de até 6 gaussianas. O programa ajusta os pontos experimentais (obtidos digitalizando-se o espectro à ser ajustado) por uma soma de gaussianas, cujo número, tem que ser previamente fixado. Os parâmetros das gaussianas [H(meia largura (cm⁻¹) na metade da altura do pico), altura do pico em densidade óptica (D.O) e posição do pico em cm⁻¹] são previamente estimados por ajuste manual e fornecidos ao programa. O "background" é aproximado por uma reta do tipo y = a + bx cujos parâmetros <u>a</u> e <u>b</u> são fornecidos ao programa. Além desses parâmetros ajustados e dos respectivos desvios, o programa fornece a área sob cada pico e também o desvio de cada ponto experimental em relação ao espectro ajustado. O critério utilizado na escolha do melhor ajuste do espectro por soma de 4,5 ou 6 gaussianas foi o da escolha daquele que apresentasse os valores dos parâmetros (ajustados) com o menor desvio. Portanto concluiu-se que o melhor ajuste é obtido por soma de 5 gaussianas onde se obtém, no ajuste mais desfavorável, um desvio de 17% para os valores dos parâmetros ajustados.

Na Figura 19a são mostrados os espectros de absorção e letrônica do H_2O^- (medido experimentalmente a 52K) e sua estrutura obtida do ajuste por soma de 5 gaussianas. Os valores dos parâmetros (ajustados) e a área sob cada banda dessa estrutura estão relacionados na Tabela VI.

V.2.1 - Estudo com a Temperatura



Figura 18 — Transição de Modo Local, Ativa no Infravermelho, do Centro H₂O⁻ em KCi. Efeito de Temperatura e Desvio Isotópico



Figura 19 — Ajuste da Banda de Absorção Óptica Eletrônica do Centro H₂O⁻ em 1401 à 52K e 160K, por Soma de 5 Gaussianas. As Bandas A, D, B, C, E que Compõem esse Estrutura Foram Desenhadas Utilizando-se os Parâmetros da Tabela VI

Efetuou-se várias medidas do espectro de absorção óptica eletrônica do centro H_2O^- numa amostra de KCI: OH⁻ em várias temperaturas, a fim de estudar a variação da forma da banda com a temperatura. As diferentes formas dessa banda são mostradas na Figura 20, para as seguintes temperaturas da amostra: 52 K, 77 K, 100 K, 120 K, 160 K e 200 K.

Utilizou-se o programa de computador (mencionado no item anterior) para decomposição da estrutura da banda H_2O^- à 160K em 5 gaussianas. Na Figura 19b são mostradas a banda H_2O^- e sua sub-estrutura (à T = 160K).

			(CEN1	RO H ₂ 0	EM KCI)			
			Parâ	imetros A	justados			
Banda	Pos. do Máximo (cm ⁻¹)		Meia Largura (cm ⁻¹)		Altura do Pico (D.O)		Área (banda i) Área total	
	52K	160K	52K	160K	52K	160K	52K	160K
Α	16838	15220	694	472	0,316	0,084	20,4%	3,6%
D	18572	16759	594	958	0,366	0,117	20,2%	10,1%
B	19604	18691	579	1276	0,348	0,502	18,7%	58,2%
С	21045	21636	1728	1318	0,206	0,114	33 %	13,7%
E	23860	22641	2351	2304	0,035	0,069	7,7%	14,4%

Tabela VI

Comparando as Figuras 19a e 19b observa-se que ocorrem mudanças nas áreas sob cada banda da sub-estrutura, com o aumento da temperatura embora a área total seja mantida constante com um desvio máximo de 2,3%. Inicialmente a 52K, as áreas sob as bandas A, D, B, C, E representam respectivamente 20,4%; 20,2%; 18,7%; 33,0% e 7,7% da área total da banda H_2O^- (estruturada). Já à 160K as áreas sob as bandas A, D, B, C, E, representam respectivamente 3,6%; 10,1%; 58,2%; 13,7% e 14,4% da área total sob a banda H_2O^- . Esse resultado mostra que há uma aparente redistribuição de população das diversas transições eletrônicas com o aumento da temperatura, modificando sensivelmente a sub-estrutura dessa banda e indicando uma possível mudança na simetria do centro.

V.3 - Fotodissociação do Centro H2O⁻ em KCI

Observou-se uma nova propriedade do centro H_2O^- , que foi a sua fotodissociação no estado eletrônico excitado a baixa temperatura. O centro H_2O^- quando exposto à luz de comprimento de onda na região da sua banda de absorção eletrônica pode dissociar-se produzindo outros defeitos. A fotodissociação do H_2O^- foi observada em vários haletos alcalinos (KCI, KBr, RbCI, KbBr) e detalhada para o KCI, como se descreve a seguir.



Figura 20 - Efeito de Temperatura na Absorção Óptica Eletrônica do Centro H2O° em KCI

V.3.1 -- Fotodissociação à 77 K

Realizou-se dois experimentos de fotodissociação de H_2O^- a 77 K em diferentes amostras de KCI. No primeiro experimento (Experimento 1, Amostra 1) iluminou-se a amostra 1 com luz monocromática de comprimento de onda coincidente com o máximo da banda H_2O^- . A geometria e a fonte de luz monocromática utilizada nesse processo foi a do espectrofotômetro "Carl Zeiss", conforme mencionado na seção III.6. As fendas de entrada e saída de luz no monocromador, utilizadas foram: de 2 mm e 5 mm (tipo S-5) respectivamente. Os resultados obtidos nesse experimento podem ser vistos na Figura 21. Nessa figura observa-se um incremento na intensidade da banda U_2 e da banda OH⁺ correspondente a um decréscimo na intensidade da banda H_2O^- , indicando a formação de centros U_2 e OH⁺ a partir da fotodissociação do centro H_2O^- .

Fazendo-se um gráfico do decréscimo do máximo da banda $H_2O^- \Delta D.O(H_2O^-)$, versus o incremento do máximo da banda U_2 , $\Delta D.O.(U_2)$, e do máximo da banda CH^- , $\Delta D.O(OH^-)$, obtidos na Figura 21, construiu-se a Figura 22. O comportamento linear obtid², mostra que os incrementos $\Delta D.O(U_2)$ e $\Delta D.O(OH^-)$ são sempre proporcionais ao decréscimo $\Delta D.O(H_2O^-)$, indicando que a formação dos centros U_2 e centros OH^- , nesse processo, provém da destruição dos centros H_2O^- , por excitação óptica (fotodissociação).

Tendo em vista esses resultados e também o fato de que o centro H_2O^- é produzido termicamente por um centro U_2 (H_i^o) e um centro OH⁻ (conforme foi discutido no item IV.1.5), conclui-se que a equação para a fotodissociação do centro H_2O^- é a seguinte:

$$\begin{array}{c} H_2 O^- \\ + h_{\mathcal{D}} (H_2 O^-) \\ \hline T \leq 77 \\ \kappa \end{array} + \begin{array}{c} H_i^o \\ H_i^o \end{array} + \begin{array}{c} OH^- \\ OH^- \end{array}$$
(34)

Essa equação que consiste numa reversão da reação expressa na equação, (17) de formação de H_2O^- , propõe que se deve observar um número de centros U_2 produzidos igual ao número de centros OH⁻ produzidos e ambos iguais ao número de H_2O^- fotodestruídos. A fim de verificar se realmente são produzidas quantidades, iguais de centros U_2 e de centros OH⁻ após a fotodissociação, efetuou-se um gráfico (para o experimento 1) de $\Delta D.O(U_2)$ contra $\Delta D.O(OH^-)$, obtidos da Figura 21, obtendo-se a Figura 23-A. O comportamento linear obtido indica que a proporção entre os incrementos das bandas U_2 e OH⁻ é constante. Utilizando-se o coeficiente angular (extraído da reta da Figura 23-A) e a fórmula de Smákula (6) obtém-se a constante de proporcionalidade entre o incremento da concentração de U_2 , $\Delta N(U_2)$, e o incremento da concentração de OH⁻, $\Delta N(OH^-)$, como segue:

$$\Delta N(U_2) f_{U_2} = C \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_{U_2} H(U_2) \Delta D . O(U_2)$$

$$\Delta N(OH^{-}) f_{OH^{-}} = C \left[\frac{n}{(n^{2} + 2)^{2}} \right]_{OH^{-}} H(OH^{-}) \Delta D \cdot O(OH^{-})$$

portanto

$$\frac{\Delta N(U_2)}{(n^2 + 2)^2} = \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2}\right]_{U_2} \left[\frac{(n^2 + 2)^2}{n}\right]_{OH^-} \frac{f_{U_2} H(U_3) \Delta D \cdot O(U_3)}{f_{OH^-} H(OH^-) \Delta D \cdot O(OH^-)}$$
(35)

com:

- intensidade de oscilador⁽³³⁾ (à 77K):
$$f_{U_2} = 0.33$$
; $f_{OH} = 0.14$

48



Figure 21 - Mudanças Relativas no Espectro de Absorção Óptica Eletrônica de uma Amostra de KCI à 77K, Contendo Centros H₂O⁻, Quando Iluminada com Luz (523 nm) Coincidente com o Máximo da Banda H₂O⁻. Nessa Figura Pode-se Notar o Crescimento das Bandas U₂ e OH⁻ em Consequência do Decréscimo da Banda H₂O⁻

3



Figura 22 - Gráfico do Decréscimo do Máximo da Banda H₂O⁻ Versus o Incremento do Máximo da Banda U₂ e do Máximo da Banda OH⁻ Durante o Processo de Fotodissociação do Centro H₂O⁻ em KCL



Figura 23 - A. Crescimento do Máximo da Banda U₂ em Função do Crescimento do Máximo da Banda OH[®] Durante a Fotodissociação do Centro H₂O[®] no Experimento 1.

B. Idem A, para Experimento 2.

A Fotodissociação em B é Realizada na Presença de Maior Número de Centros O[®] do que a Fotodissociação em A. Em Consequencia disso, tem-se maior Número de Centros OH[®] Produzidos em B do que em A

- razão entre as larguras à meia altura⁽³³⁾: $\frac{H(U_2)}{H(OH^-)} = 0,69$
- Indice de refração estimado para 52K \leq T \leq 77K, no máximo da banda: n_{U2} = 1,604; n_{OH}- = 1,645

Substituindo-se esses valores e o valor obtido para o coeficiente angular $\frac{\Delta D.O(U_2)}{\Delta D.O(OH^-)} = 2,89$ na expressão (35) vern que $\frac{\Delta N(U_2)}{\Delta N(OH^-)} = 0,90$. Esse resultado mostra que nesse experimento de fotodissociação de H2O⁻, são detetados, em média, um número de centros OH⁻ 10% maior do que o número de centros U_2 . Como esse processo de fotodissociação é efetuado na presença de centros O⁻ – produzidos inicialmente na fotodissociação do OH⁻, conforme mencionado na seção IV.1 — pode ocorrer que alguns centros U₂ produzidos na fotodissociação do H₂O⁻ adquiram energia cinética tal que nontrem o seu anti-centro O⁻ produzindo centros OH⁻, sendo esse processo mais eficiente quanto maior for o número de centros O⁻ disponíveis. Para verificar essa hipótese resolveu-se efetuar outro experimento (Experimento 2, Amostra 2) análogo ao anterior, utilizando a fenda de 1 mm para entrada e a fenda de 5 mm (tipo S-5) para a saída do monocromador. A fenda de entrada foi reduzida de 2 mm para 1 mm apenas para tornar o processo mais lento, reduzindo aproximadamente à metade o número de fotons incidentes na amostra. Nesse experimento utilizou-se uma amostra de KCI contendo além dos centros H₂O⁻ e OH⁻, um número maior de centros O⁻ do que na amostra utilizada no experimento anterior, pois obteve-se uma conversão inicial de OH⁻ em U₂ e O⁻ de \sim 42% (amostra nº 2). No experimento anterior à este a conversão inicial de OH⁻ em U₂ e O⁻ foi de \sim 33% (experimento 1, amostra 1).

O resultado desse experimento é apresentado na Figura 23-B onde se fez um gráfico do incremento do máximo da banda U2 em função do incremento do máximo da banda OH⁻. Obteve-se um comportamento linear semelhante ao da Figura 23-A mas com coeficiente angular diferente. Substituindo-se o valor do coeficiente angular da reta inclusa na Figura 23-B, $\frac{\Delta D.O(U_2)}{\Delta D.O(OH^-)} = 2,08 \text{ e os}$

valores (anteriormente utilizados) dos parâmetros (H,f,n) na expressão (35) vem que $\frac{\Delta N(U_2)}{\Delta N(OH^-)} = 0.65$.

Esse resultado mostra que nesse experimento (nº 2) de fotodissociação de H_2O^- são detetados em média, 35% mais centros OH⁻ do que centros U₂. Isto confirma a hipótese anterior de que o excesso de OH⁻ detetado após a fotodissociação do H₂O⁻ seja devido à recombinação de uma parte dos centros U₂ - também produzidos nesse processo - com os centros O⁻ presentes. Uma comparação entre o primeiro e o segundo experimento mostra que no segundo onde o número de centros O⁻ presentes durante a fotodissociação é maior do que no primeiro, há um excesso de 21% de OH⁻ e no primeiro experimento há um excesso de 5% de OH⁻ em comparação com a proporção 1:1 proposta na equação (34).

Do acima descrito já se pode parcialmente concluir que os defeitos que compõe o centro H_2O^2 são OH⁻ e U₂ (H^o₂). Com base nesses resultados, supondo-se então que cada centro H₂O⁻ dissociado produz um centro H^o e um OH⁻, pode-se estimar as intensidades de oscilador das bendas que compõe a estruturalida banda H2OT. Para tanto, em qualquer processo com mais ou menos centros OT disponíveis, o número de centros H2O⁻ destruídos é igual à média aritmética das quantidades de centros OH⁻ e U2 produzidós!" Para mostrar isso, utilizou-se aqui o valor da intensidade de oscilador (total) da banda H_2O^- , $\Sigma f_{H_2O^-} = 0.62$ (que será calculado a seguir). Utilizando-se o método da pesagem calculou-se a área equivalente ao decréscimo da banda H₂O⁻ entre os espectros 1 e 6 da Figura 21 devido à destruição de N_{H2O}- centros H2O⁻. Essa área (por pesagem) é equivalente à área de uma gaussiana hipotética cujos parâmetros H (altura do pico em D.O) e σ (largura em e V à meia altura) estão relacionados por Årea (por pesagem) = 1,2533 H(D.O). σ (eV). Assim calculou-se N_{H 2}O - utilizando a formula de Smákula (6) para uma gaussiana equivalente, de mesma área, com H. $\sigma = \frac{A_{rea} (por pesagem)}{1,2533}$ e intensidade de oscilador total igual a 0,62. O valor obtido foi $N_{H_2O^-} = 0,0179C$; (C = constante). Os aumentos

equivalentes (medidos) nos densidades ópticas dos máximos das bandas U₂ e OH⁻ foram: $\Delta D.O(U_2) = 0,163 e \Delta D.O(OH^-) = 0,068$. Utilizando os seguintes valores dos parâmetros encontrados na literatura: f_{U2} = 0,33, f_{OH⁻} = 0,14, n_{U2} = 1,604 e n_{OH⁻} = 1,645 (índice de refração no máximo da banda/, obteve-se N_{U2} = 0,0159 C e N_{OH⁻} = 0,022C que são respectiv/ mente as concentrações de centros U₂ o OH⁻ produzidos. Portanto obtém-se que: $\overline{N} = \frac{N_{U2} + N_{OH^-}}{2} = 0,0189C$. Comparando \overline{N} com N_{H2O⁻} verifica-se que $\overline{N} = N_{H2O⁻}$ dentro de um desvio de 6% do valor de N_{H2O⁻}. Com base nesses resultados propõe-se a seguinte equação para esse processo:

$$\begin{array}{c} H_2 O^- \\ H_2 O^- \end{array} + h\nu (H_2 O^-) \xrightarrow[]{T \leq 77 \ K} H_i^0 + OH^- ; H_i^0 (movel) + O^- \longrightarrow OH^- (36) \end{array}$$

Utilizando esses resultados calculou-se a intensidade de oscilador-total de banda H_2C^- - resultante da soma tória das intensidades de oscilador correspondente às cinco bandas que compõe essa estrutura; $\Sigma f_{H_2O^-} = f_A + f_B + f_C + f_D + f_E$. O método utilizado foi o da comparação entre áreas como será descrito a seguir. As áreas $A_{H_2O^-} = A_{U_2}$, respectivamente, sob as bandas H_2O^- e U_2 entre os espectros 1 e 6 da Figura 21, foram obtidas pelo método da pesagem. Tendo em vista o resultado anterior que mostrou haver no experimento 1 um consumo de 5% dos centros U_2 produzidos (na fotodissociação do H_2O^-), devido à sua recombinação com centros O^- , corrigiu-se o valor medido da área A_{U_2} acrescentando-se a ele 5% do seu valor. Assim a razão obtida entre as duas áreas é dada por $A_{H_2O^-}$

 $\frac{A_{H_2O}}{A_{U_2}} = 1,742$. Sabe-se que a fórmula de Smákula também pode ser escrita em termos da área sob a

gaussiana. como segue: Nf = C Área $\frac{n}{(n^2 + 2)^2}$ onde C é uma constante. Utilizando essa expressão para a $A_{H_2O^-}$

razão $\frac{A_{H_2O^-}}{A_{U_2}}$ medida vem :

$$\frac{\Delta N_{H_2O^-}}{\Delta N_{U_2}} \frac{\Sigma f_{H_2O^-}}{f_{U_2}} \left[\frac{(n^2 + 2)^2}{n} \right]_{H_2O^-} \left\{ \frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_{U_2} = 1,742$$

O número de centros H_2O^- destruídos é igual ao número de centros U_2 produzidos pois já efetuou-se a correção de 5%, portanto $\frac{\Delta N_{H_2O^-}}{\Delta N_{U_2}} = 1$.

Assim

$$\Sigma f_{H_2O^-} = 1,742 \left[\frac{n}{(n^2 + 2)^2} \right]_{H_2O^-} \cdot \left[\frac{(n^2 + 2)}{n} \right]_{U_2} \cdot f_{U_2}$$
(37)

substituindo-se os valores dos parâmetros utilizados em (35), $f_{U_2} = 0.33$, $n_{H_2O} = 1.496$ e $n_{U_2} = 1.604$, na expressão (37), obtém-se o seguinte valor para a intensidade de oscilador total da banda H_2O^- em KCI (a 77 K): $\Sigma f_{H_2O} = 0.62$. Esse valor encontrado para $\Sigma f_{H_2O}^-$ pode ser interpretado por uma distribuição de carga eletrônica onde 62% são responsáveis pela absorção de luz ne região da banda F — produzindo a banda H_2O^- — sendo que os restantes 38% permanecem distribuídos pelas 6 cargas positivas da primeira coordenação.

Como a área total da banda H_2O^- se mantém constante com a variação da temperatura (entre 52K a 160K) isto implica que a intensidade de oscilador total independe de T portanto:

$$f_{H_2O^-}$$
 (total)_{52K} $\stackrel{=}{=}$ $f_{H_2O^-}$ (total)_{160K} $\stackrel{=}{=}$ 0,62 (valor medido a 77K)

Utilizando esse valor para a intensidade de oscilador total da banda H_2O^- e os valores das áreas sob as bandas A, D, B, e E que compõe a estrutura da banda H_2O^- , ver Tabela IV, calculou-se as intensidades de oscilador para cada banda componente, nas temperaturas de 52K e 160K pelo método comparativo entre áreas, como segue:

$$\frac{f_i}{\Sigma f_{H_2O^-}} = \frac{\hat{A}rea (banda i)}{\hat{A}rea (banda H_2O^-)} \quad onde \quad i = A, D, B, C, E$$

fi é a intensidade de oscilador da banda i.

Os valores f; assim calculados encontram-se na Tabela VII.

V	H
	a Vi

Banda	Intensidade de Oscilador (f)			
em KCl	T = 52K	T = 160K		
A	0,13	0,02		
D	0,13	0,06		
8	0,12	0,36		
с	0,21	0,08		
E	0,05	0,09		

Esta variação de f em alguns casos de até um fator de 5 (transição A) leva à suposição de que o centro H_2O^- tem simetria muito baixa encontrando-se numa configuração tal que as transições apresentadas sofram uma forte dependência com a temperatura. À baixas temperaturas, a simetria sendo menor faz com que transições inicialmente proibidas a temperaturas altas sejam permitidas. A altas temperaturas, transições tipo B e E são favorecidas em detrimento das demais que vão contribuir com as de maior probabilidade. Comparando os parâmetros, meia largura e posição de arco, da banda B a 160 K (Tabela VI) com os parâmetros da banda principal do centro F, verifica-se que dentro de um desvio de 5% esses parâmetros coincidem. Isto significa que para temperaturas ~ 160K a simetria do centro muda de tal forma que sua transição eletrônica de maior probabilidade (ocupando maior área) se aproxima à do centro F,

V.3.2 - Estudo da Fotodissociação do H2O⁻ com a Temperatura

Foram efetuados vários experimentos de fotodissociação do centro H_2O^- em KCI nas seguintes temperaturas: 52 K, 77 K, 90 K, 105 K, 120 K e 150 K, iluminando-se sempre no máximo (correspondente à temperatura da fotodissociação) da banda H_2O^- com fendas de 1 mm na entrada e 5 mm (tipo S-5) na saída do monocromador e geometria já descrita anteriormente. Os pontos experimentais para cada experimento de fotodissociação numa temperatura T foram ajustados pelo método dos mínimos quadrados à uma curva do tipo $D.0 = D.0_0 e^{\alpha t}$ onde t é o temps de iluminação. Do ajuste obtém-se α (cujo inverso é τ ; tempo de relaxação na temperatura T). Nos vácios ajustes efetuados, nesse estudo, obteve-se os coeficientes de determinação, r^2 , variando entre 0,97 e 1,00, mostrando que o decaimento dos centros H_2O^- durante a fotodissociação numa temperatura fixa T obedece uma lei exponencial ou seja, um processo de primeira ordem. Os vários valores de τ obtidos dos ajustes estão relacionados na Tabela VIII.

Sabe-se que $\tau = \tau_0 e^{E/K_B T}$ onde E é a energia de ativação térmica do processo e T a temperatura absoluta da amostra. Fazendo-se um gráfico dos valores de τ em função do inverso da temperatura (dados contidos na Tabela VIII), num papel monolog, obtém-se a Figura 24. Basicamente essa figura apresenta duas regiões onde τ varia linearmente com T por ln τ varia linearmente com T⁻¹ região I para T \gtrsim 120K e região II para T < 120K. A energia de ativação é obtida a partir do coeficiente angular da reta utilizando-se a seguinte expressão:

$$E = coeficiente angular x ln 10 x K_p$$

onde K _n é a constante de Boltzmann.

Temperatura da fotodissociação (K)	Vida média <i>†</i> (min)	
52	134,7	
77	163,0	
90	188,3	
105	237,1	
120	268,5	
150	219,6	

Tabela VIII

O valor da energia de ativação, calculado utilizando-se a expressão (38), para e região I da Figura 24 é o seguinte: $E_1 = 0,0106 \text{ eV}$, mostrando que o processo de fotodissociação do centro H_2O^- torna-se mais eficiente com o sumento da temperatura (em que se processa a fotodissociação) a partir da ~ 120K. A região II mostra que o processo de fotodissociação do centro H_2O^- torna-se menos eficiente à madida que eleva-se o valor da temperatura de 52K para 120K. Essa diminuição (observada na região II) de eficiência da fotodissociação com o aumento da temperatura (de 52K até 120K) foi interpretada como sendo devida à mudança da intensidade das bendas gaussianas, que compõe a estrutura da principal benda de absorção eletrônica do centro H_2O^- , com o aumento da temperatura ; Figura 19. Como, nesse processo, iluminou-se sempre no máximo da principal bande de absorção do centro H_2O^- a pelo fato que esse máximo está próximo do máximo da benda B da estrutura, conclui-se que:

(38)



 Figura 24 – Efeito de Temperatura no Processo de Fotodissociação do Centro H₂O⁻ em KCI. Pode-se Notar que para T > 120K o Processo Torna-se Mais Eficiente com o Aumento de T (Região I) e na Região II (T < 120K) o Processo Torna-se Menos Eficiente com o Aumento da Temperatura. A Iluminação foi Efetuada Sempre no Máximo da Banda H₂O⁻

A transição responsável pela formação da banda B favorece menos a dissociação do centro H_2O^- do que as transições responsáveis pelas bandas D e C. Isto porque em T = 52 K onde o processo de fotodissociação é mais eficiente do que em T = 120K, a banda B é menos intensa e as intensidades D e C na região do máximo (da banda H_2O^-) são maiores do que em temperaturas acima de 52K. Isto está de acordo com a suposição de mudança da população das transições.

V.4 - Modelo para o Centro H₂O⁻

Inicialmente será apresentado o modelo estrutural proposto em 1971 por Rusch e Seidel⁽³³⁾ para o centro H_2O^- . Com base em medidas magnéticas (ERS e ENDOR) eles propuseram que o centro H_2O^- é basicamente um centro F perturbado pela molécula de água embebida nele. A seguir serão goresentadas uma série de observações experimentais que contrariam a formação de molécula de água mas não o caráter de centro F desse defeito. Cabe esclarecer que todos os argumentos apresentados contrários à produção de moléculas de água são baseados em observações experimentais completamente novas (inéditas) e portanto desconhecidas pelos autores Rusch e Seidel. Por fim utilizar-se-á o caráter de centro F, proposto por Rusch e Seidel para o centro H_2O^- e os resultados do estudo com temperatura, obtidos no presente trabalho para o centro H_2O^- no estado fundamental e no estado excitado (foto dissociação) na proposição do novo modelo.

V.4.1 - Modelo Proposto por Rusch e Seidel

Rusch e Seidel^(32,33) após efetuarem várias medidas de ESR e ENDOR para o substitucional H_2O^- em KCI (à temperatura de hélio líquido) propuseram o seguinte modelo para esse defeito: O centro H_2O^- pode ser considerado como um centro F perturbado por uma molécula de água embebida nele. O elétron desemparelhado que é opticamente ativo está fortemente ligado à vacância de cloro de maneira parecida com o elétron do centro F. Essa é uma situação bem diferente da que ocorre no defeito H_2S^- onde o elétron mais extenso do defeito está ligado à molécula ocupando um orbital da mesme⁽¹⁹⁾; veja na Figura abaixo.



Na ausência de campo elétrico externo o eixo de simetria juntamente com o modelo de dipolo alétrico da molécula de água apontam aleatoriamente em qualquer uma das oito direções <111> do cristal e o eixo principal da molécula aponta numa das três direções <110> perpendiculares ao eixo molecular <111>. A vacência de cloro (diâmetro ~ 3,72 Å) é bem maior que a molécula de água (comprimento da ligação O-H é ~ 0,96 Å). A molécula de áqua dentro dessa vacência sofre successivas reorientações entre as possíveis direções <111>. Em temperaturas de hélio líquido o tempo de reorientação, τ , é da ordem de segundos. Em temperaturas maiores (acima de 30K) o tempo da reorientação tem uma dependência do tipo Arrhenius: $\tau = \frac{1}{\nu_o} \exp\left(\frac{E_o}{KT}\right)$ onde $E_o \sim 0,025 \text{ eV} e \nu_o \sim 10^{14} \text{ seg}^{-1}$. Nesse caso o tempo de

reorientação torna-se tão pequeno que se observa um movimento médio de rotação da molécula dentro da vacância. Dos efeitos de alinhamento do dipolo com o campo aplicado e da variação provocada no espectro de absorção óptica com luz polarizada, Rusch e Seidel mediram a intensidade do dipolo elétrico para o centro H_2O^- à temperatura do hélio líquido:

V.2.4 - Argumentos e Proposição de um Novo Modelo

Primeiramente serão enumerados e discutidos nossas observações experimentais que contrariam a hipótese da existência estrutural da molécula de água. Em seguida será proposto nosso modelo.

1 - A fotodissociação do centro H_2O^- por iluminação com luz visível ~ 2 eV na região da sua banda de absorção eletrônica produzindo centros U_2 e OH^- indica que se houvesse uma molécula de água dentro da vacância, haveria necessidade da rede fornecer uma energia adicional de no mínimo 2,8 eV para a dissociação de uma das ligações O-H cuja energia média de ligação é 4,8 eV.

2 – A formação de centros U juntamente com a deformação de centros H_2O^- em igual número, durante a destruição térmica dos centros U_{2x} em KBr, indica que as energias finais das configurações resultantes: a) $H^- + OH_i^0$ ou b) H_2O^- são iguais. Esse argumento contraria a formação de moléculas de água, pois não há preferência entre a configuração final <u>a</u> ou <u>b</u> indicando que na configuração <u>b</u> tem-se um hidrogênio aprisionado dentro da vacância pelo (on OH⁻. Se houvesse a formação de molécula de água em <u>b</u> não haveria um processo competitivo entre <u>a</u> e <u>b</u>.

3 – A formação de centros U após a destruição térmica dos centros H_2O^- em KCI, mostra que caso houvesse molécula de água, a rede deveria fornecer ~ 4,8 eV (no mínimo) para a quebra de uma das ligações O-H da molécula, sendo que a energia de ativação térmica obtida para esse processo, foi de aproximadamente 0,8 eV (Tabela I). No modelo proposto por Rusch e Seidel^(32,33), a destruição térmica do centro H_2O^- produz um centro F e uma molécula de água intersticial isto é, não há dissociação da ligação O-H da molécula. Eles entretanto não mediram a ativação térmica do processo que cria F e (H_2O)_i.

4 – Não se detetou absorções no infravermelho de moléculas de água intersticiai», após a destruição térmica dos centros H_2O^- em «CI.

5 – Detetou-se um modo vibracional do centro H_2O^- ao invés dos três modos ativos no infravermelho conhecidos para a molécula de água. Além disso o efeito isotópico medido para esse modo quando se substituiu o hídrogênio pelo dentério, apresentou um fator bem próximo de $\sqrt{2}$ indicando um comportamento semelhante ao de um oscilador harmônico simples. Isso leva à supor a presença de um próton isolado dentro da vacância, produzindo apenas um modo vibracional.

6 – A reconstituição de 90 a 95%, após tratamento térmico no final do processo, dos OH⁻ inicialmente destruídos é um forte argumento contra a produção de molécula de água intersticial estável após a destruição térmica do centro $H_2O^{--}\partial + f + ::+^\circ !^\circ gf:I + \cdots +$ final do processo, a rede teria sempre que fornecar ~ 4,8 eV para a quebra (no estado fundamente. :) defeito) de uma ligação O-H se o centro H_2O^{-} possuísse uma molécula de água.

7 - A mudança nas probabilidades das transições eletrônicas do centro H₂O⁻ com o aumento da temperatura indica uma possível dependência da simetria do centro com a temperatura, de tal forma que a probabilidade total (soma das probabilidades de todas as transições) se mantém constante. Isso

mostra que esse defeito, a temperatura de mitrogêmo líquido, possui baixa simetria e para temperaturas bem mais altas aproxima-se da simetria cúbica. Há por exemplo, transições que possuem intensidade de oscilador alterada por um fator de 5. Tais mudanças de simetria do centro com respectivas redistribuições de carga eletrônica parciais, contrariam a suposição de uma configuração na qual há formação de uma molécula de água dentro do centro F.

A configuração de molécula de água não proporcionaria uma mudança da simetria do centro com o aumento da temperatura, uma vez que a molécula de água tem simetria bem determinada. Essa forte dependência da simetria com a temperatura é mais adequada a uma configuração na qual um hidrogênio está aprisionado pelo (on OH⁻ dentro da vacância, mas aparentemente mais distante que o hidrogênio do (on OH⁻.

Com base nesses argumentos propõe-se o seguinte modelo na formação do defeito H_2O^- uma parte da nuvem eletrônica devida ao elétron mais extenso da molécula OH⁻ é distribuída e espalhada na vacância, de forma semelhante à de um centro F, sendo que essa parte produzirá uma banda de absorção eletrônica com intensidade de oscilador igual a ~ 0,6. Isso pode ser entendido como que ~ 60% da carga eletrônica do OH⁻ efetua transições na região da transição 1 s - 2p do centro F. Assim sendo, para compensar esta redistribuição de ~ 60% da carga eletrônica da molécula de OH, parte da carga eletrônica do átomo de hidrogênio mais afastado, se transfere para a molécula de OH, o que dá origem a uma ligação de caráter parcialmente covalente entre o átomo de hidrogênio mais afastado e a molécula de OH. Este modelo para o centro H_2O^- é consistente com o modelo do centro U_{2x} o que de certa forma se constitui numa configuração intermediária antes de sua aniquilação térmica e posterior formação do centro H_2O^- .

Nesse modelo o centro H_2O^- pode ser também imaginado como um centro F perturbado, contendo uma molécula OH com um átomo de hidrogênio nela aprisionado, tendo-se portanto dois prótons a distâncias distintas do oxigênio nesse defeito. O comprimento da ligação do hidrogênio que é aprisionado pela molécula OH, deve ser maior do que 0,96 A que é o comprimento da ligação O-H. A configuração deste centro a temperaturas abaixo da temperatura do nitrogênio líquido não deve diferir muito da proposta por Rusch e Seidel, mas a temperaturas maiores a simetria muda produzindo variações bem acentuadas nas probabilidades das transições eletrônicas.

O modo vibracional observado é explicado como o estiramento da ligação H ------ OH. A energia desse modo vibracional é menor do que a energia do modo vibracional de estiramento da ligação O-H por um fator igual a 2,66. Isso pode ser explicado pelo fato da constante de força da ligação H ------ OH ser menor do que a constante de força da ligação O-H pois a energia da ligação H ------ OH (~ 0,8 eV) é menor do que a energia da ligação O-H (4,8 eV)

A confirmação dos modelos propostos neste trabalho poderá ser obtida com uma sofisticação da técnica de absorção óptica como por exemplo, medidas de dicroísmo associadas a medidas elétricas e paramagnéticas.

APÉNDICE A

AJUSTE DE PONTOS POR UMA CURVA EXPONENCIAL

Os ajustes de n pares de pontos experimentais $\{(x_i, y_i)\}$ por uma curva exponencial foram efetuados utilizando se o método dos mínimos quadrados onde $y_i > 0$ para uma função exponencial da forma $y = a e^{bx}$ (a > 0). A equação anterior é linearizada na forma $\ln a + bx$ a partir de qual os coeficientes a e b são calculados a partir das expressões:

$$\mathbf{b} = \frac{\sum \mathbf{x}_{i} \, \ln \mathbf{y}_{i} - \frac{\mathbf{i}}{n} \, (\Sigma \, \mathbf{x}_{i}) \, (\Sigma \, \ln \mathbf{y}_{i})}{\sum \mathbf{x}_{i}^{2} - \frac{\mathbf{i}}{n} \, (\Sigma \, \mathbf{x}_{i}^{2})}$$

.

$$a = \exp \left[\frac{\Sigma \ln y_i}{n} - b \frac{\Sigma x_i}{n}\right]$$

A qualidade do ajuste é dada pelo coeficiente de determinação r² expresso por

$$r^{2} = \frac{\left[\sum x_{i} \ln y_{i} - \frac{1}{n} \sum x_{i} \sum \ln y_{i}\right]^{2}}{\left[\sum x_{i}^{2} - \frac{\left(\sum x_{i}\right)^{2}}{n}\right] \left[\sum (\ln y_{i})^{2} - \frac{\left(\sum \ln y_{i}\right)^{2}}{n}\right]}$$

O coeficiente de determinação pode assumir valoras compreendidos entre 0 e 1. Em particular $r^2 = 1$ corresponde a um ajuste de 100% dos pontos experimentais à curva traçada.

APENDICE B

	C 1 4 4 4 5	a a contrava	E.I. VALSA	TEAN OF FE	TTING FUNCT	T T ON	
0.1.21	r MAIS	1 - * ** 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		16NA (2001 -	YETT(200).		201
10.00	1	e e se	4F A4DE1 9	1			
1111		 Managements 					
1.1.1.1	141	- 24 4 16 - 411 Eko 490 El - 2 - 444 Eko 444 - 4	[],]=[,]9	•			
11.	1	 A. 1977 (1994) A. 1977 (1994) 	(1).(=1.1	9)			
	?	1					
1961		Constraints of the second	VPTS, NPFA	ĸ			
7774	491	1 9411115)					
וררך			NPTS, NPT 2015 - 1.12	AK .18.9 EVPE	e. POCNIST.	TR. PEAKS	FITTED")
111		eranti anni La(F		G*4.11.1=1	.8.		
יורר	990	1 1 1187 (6.7 3.41					
יןרר		$(0,1,2,1) \stackrel{*}{\rightarrow} (-1,1) \stackrel{*}{\leftarrow} (1,2) \stackrel{*}{\leftarrow} (-1,2) \stackrel{*}{\leftarrow} (-$),Y(T),ST	G44111,1=9	,NFT5)		
0114	997	1 129415 (601 3,11					
0116	115		×	*	SIGHA	x	¥
	,	1 (10941)					
1111		#211114 A1171 181	11. 111.5	IGHAII), [=	1,81		
2014	110	F 10 41 1 (11 , 16 10 ,	4,8 8,7€ <u>1</u> 	7.4} 584/11 1.5			
0.010	120	- WS 17 - 15+12911311 - 6 38 MATERNE, 6610 -	/***!/*31 1)	G-A(1),149	678P 1 31		
0021	120	NTEON CAPEAK+32+	2				
0722		NPQ-NOTAK#3					
2023		W017515,1223					
00.24		PLADES+40334(1)+	A[2]				
0025	101	FORMAT[25]2.4]					
7774	101	REATES (791) [AIJ]	, J= 3, MIEH	- 1			
0078	,	9649 377 YESTE					
n72.	127	EN2441(14)					
9330	122	FORMATCHES, FINLT	TAL VALUE	OF PARAME	TERS*+/}		
00.31		WR[7=14,124] A11	1,4(2)				
0032	124	- FUD MATE - +F10.8	•/•• ••F1	0.71 CDM1			
()() 3 4	175	- WM3 (217)177 141 - CORNATI, 1-F10-3	J/, **),***	6441			
20,35		WRITE(6.137)					
0034	130	FORMATI'L', BEGI	NNING OF	FITTING PR	OC EDURF!!		
0137		FLAMD=. 101					
0039		MNINV=7					
9037	67	-01 12 12149815 VE17(1)=FUNCTIX-	I.A.NPOL				
2041	02	FREE=NPTS-NTERM					
0042		CHIST=FCHIQIY+ST	GHA.NPTS.	MODE.VEIT1	/FREE		
0043	23	WRITFI6,793)CHIS	1				
0744	793	FORMATE THODEV =	•F15.3)	NTCOM MOO	-		
20142		IR.NPG.SGI	119-48-68-12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CINIUELIAN		
0045		1F(MNINV) 324, 325	, 324				
0047	325	TELANSICHISI-CHI	QR)01+C	HIQR130,30	.25		
0048	25	CHISL=CHIOR					
0049		GO TO 23					
0050	317	107 47 1=170PEAN 153#(1=13					
0052	40	AREA(1)+2+5066#4	(J+3)+A(J	(+5)			
0051		00 50 1=1,NPTS					
0154		VFITIII=FUNCTIX,	1,A,NPQ)				
0055	50	CONTINUE					
70 56		- WR3TE(6,135)					
0058	117		C VALUE !	IP PARAMPTE	M2.1		
0059	139	FORMAT1.0.,. P	APAM.	ST. DFV.	•)		
0060		WRITE(6,996) (AL	J1+5G(J),	J=1+21			
0061	796	FORMAT(* **FLO.8	•	F10.81			
0063	997		31+561374	J#3+NTERM)			
0064		WRITE(6,140)					
0065	140	FOPMATE11.,	FXP	CALC	(EXP-CALC	1 (EXP-CALC)	++2*)
0066		00 73 1=1.NPTS					
9067 0040		214711)-VFIT(1) 20421421					
6900		27771771 WRITF(6_1503V(1)	.YEIT().	21.72			
0070	150	FORMATI 4F12.	3)				
0071	73	CONTINUE					
0072		WRITF(6,155)					
0073	155	- FORMATETT - TARFA - URTTELA TARIANE	UNDER PE	48511			
0075	160	FORMAT(+0+_F10_3		NUT NE			
0076	324	1FEKESTE1326.347	, 326				
0077	326	STOP					
7778		F 40					

	C
0001	SUMO THTINE EDEPTIX, 1, A, DELTA, NPQ, DEPIVI
0002	DIMENSION KIZODI,AIZOI,DELIAIZOI,UEMINIZUI
0003	11 ×1=×(1)
0004	21 DEPIVITI#1.
9305	DEPIV(7)=X[
0006	nn 25 J=3,NPQ,3
0007	/=(\1-A(J+\))/A(J+2)
0004	17=1+1/?.
(+)09	1F(/?=70.)72,22,?3
2010	23 DEPIV(J)=0.
0011	G(1 T) 24
. 0012	22 NFPIV(J)=FXP(-22)
100 -	26 DERIV(J+1)=A(J)+DERIV(J)+Z/A(J+2)
0014	DEPTV(J+2)=DERIV(J+1)+2
0015	25 CONTINUE
0016	PFTUPN
0017	FND
	C FUNCTION FORTO
	C EVALVATE CHI SQUARE FOR FIT TO DATA
	<pre>C FCH1Q=SUM (Y-YF1T)##2/SIGMA##2)</pre>
0001	FUNCTION FCHIQ(Y,SIGMA,NPTS,MODE,YFIT)
0002	DIMENSION VIZOOD,SIGMA(200),VEIT(200)
0003	CH150=0.
0004	DO 30 [=1.NPTS
0005	IF (MODE) 22, 27, 29
0006	27 IF (V(1))25+27+23
0007	23 WEIGH=1+/Y(1)
0008	60 10 30
0009	25 WFIGH=1./(-Y(1))
0010	GO TO 30
0011	27 WFIGH=1.
0012	GO TO 30
0013	29 WEIGH=1+/SIGMA(I)++2
0014	30 CHISQ+CHISQ+WEIGH+(V(I)-VFIT(I))++2
0015	FCHTQ=CH15Q
0016	RETURN
0017	END
	C FUNCTION FUNCT
0001	FUNCTION FUNCTIX, 1, A, NPQ)
0002	DIMENSION X(200), A(20)
0003	1 x[*x([)
0004	2 FUNCT=A(1)+A(2)+X1
0005	3 00 19 J=3,NPQ,3
0006	4 Z=(X1-A(J+1))/A(J+2)
0007	5 22=7+7/7.
0005	15(72-70,110,10,20
0009	20 D=0.
0012	GO TO 15
0011	10 D=FxP(-72)
0012	15 FUNCT=FUNCT+A(J)+D
0013	19 CONTINUE
0014	RFTUON
0015	END

9071	\$(100-7)]T [4]F - 4AT [N] ARRAY • N(3RDF • '3F T F
0002	01469/104 ARRAY(20,20),EK(20),JK(20)
0003	10 011-1
0374	FT 100 F.201 K = 5 P.400 M OL
	C
	C FIND LARGEST FLEWENT ARRAYLT, JE IN REST OF MATRIX
0005	A M A Y - 7 -
1106	X1 DO DO TERTONOC
1007	717 3.0 J=# +NJRDE
0008	23 F[(A45[A4AX)-AB5[ARRAV([,J)]] 24,24,30
0000	74 AMAY - ADDAVIT - 11
0010	(k (k) =)
0011	JK (K) = J
2012	30 CENTINUE
	r
	THE THE CHANCE DOLE AND COLUMNE TO DUT ANALY IN ADDAVIN
	C INTERPORT FUNCTION AND COLUMNS IN FULL AND A THE ADDRESS OF
0013	31 TF LAYAXI 41+32+41
2014	32 ()FT=0.
0015	66 10 140
0.11	
9915	41 L=1K(K)
0017	1F(1-K) 21+51+43
0019	43 DH 50 J=1+NARDE
0010	SAVE = AQRAY(K - 1)
0000	ADDAVIA IL-ADDAVIT AL
2020	AREATIK, JJZAPRATLI, JJ
0021	50 ARRAV([,J]=-SAVF
0022	51 J=JK{K}
0021	151 1-81 21-61-53
1112 7	
0024	23 DU 60 1=1+NUKUC
0025	SAVF=APRAY(I,K)
0026	ARRAY(I,X) = ARRAY(I,J)
0027	AD ADDAWLT INSAVE
0.071	
	C
	C ACCUMULATE ELEMENTS OF INVERSE MATRIX
0029	61 DD 70 1=1+NORDE
0020	16(1-K) 63-70-63
0027	
90 1 0	63 ARPAT(1,K)=-ARKAT([,K)/AMAX
0131	70 CONTINUE
0032	71 DO 40 [#]+NORDE
0011	
0000	
90 14	1F11-KJ (4,80,74
9035	74 1FlJ-K) 75,80,75
0036	75 APRAY(1,J)=ARRAY(1,J)+ARRAY(1,K)+ARRAY(K,J)
0037	80 CONTINUE
0038	
0039	HI DO 40 JEI-NORDE
0039	IF(J-K) 93,90,93
0040	R3 APRAV(K.J)=ARRAV(K.J)/AMAX
0041	90 CONTINUE
0067	
20042	
0743	107 DETERPTOR
	C
	C RESTORE ORDERING OF MATRIX
0044	
0044	VI OU LTT ETIMUNUE
9947	5,7(1)))+L+L
0046	J=TK(K)
0047	JF(J-K) 172,122,105
0048	105 00 110 L=1.NORDE
0049	
0.04 7	3 M Y C 4 M Y K K Y K S K K K K K K K K K K K K K K
0050	AKHAY{I,KJ9-ARRAY{I,J]
0051	110 ARRAVII.JJ=SAVE
0052	
0053	
0084	1711-787 J 70791 30911 3
0074	115 UT 170 J=1+NORDE
0055	SAVF=APRAV(K,J)
0056	
	AMMAY1K.JJ#+AMMAY[].J]
0057	ARMAYIK,JJ#+ARKAT(,J) 120 ARDAV(1, 1)+CAVC
0057	ARRAY(1, J)=-ARKAY(1, J) 120 ARRAY(1, J)=SAVF 120 CONTAINT
0057 0059	ARPATIX,JJ=-ARKAT(1,J) 120 ARAY(1,J)=SAVF 130 CONTINUE
0957 0959 9959	ARPATIR,JJ=-ARKAT(I,J) 120 ARRAY(I,J)=SAVF 130 CINTINUF 140 RFTURN

0001	SUBPOUTTYF CURFILL,Y.SIGMA.NPTS.NTERM.MODE.A.DFLTA.FLAMD.YFIT.CHIS
	11, (HT0), NPQ, SG)
0012	DIMENSION X(200), Y(200), SIGMA(200), A(20), DELTA(20), YEIT(200)
0003	D141 4C104 WFIGH(200), ALPHA(20,20), BETA(20), DER14(20), ARRAY(20,20)
	18(20), 56(20)
00.74	
0005	
00.25	17 1 - 17 - 17 1 / 2 / 2 / 7 / 7 17 1 6 / 4 / 1 1 / 1 6 / 7 - 33
0008	22 \
0000	
0010	25 HF1GH11)=1./(-Y11))
0011	Gn tro an
0012	27 WFIGH(1)=1.
0113	G0 T0 30
0014	29 WEIGH(T)=1+/SIGMA(1)++2
0015	30 CONTINUE
	C EVALUATE ALPHA AND HETA MATPICES
0016	AL DIJ AA JELONTEKA
0017	
0010	וויי אין אבוןט אנו שאנו איבר.
0020	
0021	CALL FDERICK, L.A. DELTA.NPG.DERIV)
0022	DD 46 J=1.NTERM
0023	RETA(J)=RETA(J)+WEIGH(I)+(V(T)-FUNCT(X+I+A+NPQ))+DERIV(J)
0024	DN 46 K=1,J
0025	65_ALPHA(J_K)=ALPHA(J_K)+WEIGH(I)#OFRIV(J)#DERIV(K)
0126	50 CONTINUE
0027	51 DO 53 J=1,NTERM
0028	00 53 K=1,J
0124	53 ALPHA(K,J]=ALPHA(J,K)
	L C INVERT MONTETER CHOVATHEE MATERY TO FIND NEW BARANETERS
0030	71 D0 74 J=1.NTFRM
0031	00 73 K=1,NTERM
0032	[F[[ALPH4[],J],FQ.O.].NR.(ALPH4[K,K].EQ.0.1]GO TO 500
0033	73 ARRAY[J_K}=ALPHA[J_K]/SQRT[ALPHA[J,J]#ALPHA[K,K]]
0034	74 ARRAY(J,J)=1.+FLAMD
0035	TO CALL MATINGARRAY, NTERN, DET)
0035	AT DU AG JELENTERM Beine an in
00137	01.9F=0(J) 00.06 k=1 NTERM
0019	917 77 K-1, PNICKH 84 8113 - RETACK BARRAY 1 1. KJ / SORT (A) PMA(1., 13 PAL PMA(K.K))
	C IF CHI SQUARE INCREASED, INCREASE FLANDA AND TRY AGAIN
	r
0040	91 DO 92 1=1,NPTS
0041	92 YFIT(T)=FUNCT(X,1,8,0PQ)
0042	FREF=NPTS-NTERM
0743	93 CHIQUECHIQIY,STGMA,NOTS,NYUCE,YFITJ/FREE
0044	FI/MC-20 AF AMO
0045	77 FLAND=10.4FLAND 60 70 71
0.740	
0047	101 DD 103 J=1.NTERM
0348	Alu)=R(u)
0049	103 SG(J)=SQRT(ARRAY(J,J)/ALPHA(J,J))
0050	FLAMD=FLAMD/10,
001	RETURN CONTRACTOR
0053	nu mainys) Motecia cont
0054	PRIVING THE FULL
	IF, VERTER VIUS DATA AND THE TOUR OF US AND ANT ANT POSSING
0155	RETURN
0056	FND

ABSTRACT

In order to understand the basic mechanisms that are responsible for the thermal formation and thermal destruction of the primary and secondary defects after low energy radiation damage in alkali helide crystals doped with OH⁻, the production of defects by pulse annealing in KCI: OH⁻ and KBr: OH⁻ was studied.

These thermal processes were studied over a wide range of temperatures '52-300 K), and the several hydrogen reaction products were identified by their characteristic electronic absorption (visible-ultraviolet). Besides the well known substitucional and interstitial H_i^0 and H^- defects, a new hydrogen defect, U_{2x} center, was discovered after the thermal destruction of the U₂ centers. It is characterized by a new structureless electronic absorption band (UV) at 45000 cm⁻¹ in KCI and 40000 cm⁻¹ in KBr. From this experimental observations it was proposed that the U_{2x} center is constituted by one H_i^0 center trapped by a substitucional OH⁻, without disturbing the electronic transition of the U_{2x} centers. Furthermore, it was observed that the thermal destruction of H_2O^- centers produced: F(15%), U(60%) and OH⁻(25%) centers in KCI and F (~ 100%) in KBr. At the end of this thermal process (at 300 K), 90 to 95% of the initial OH⁻ centers were restored at the expenses of F and U centers.

Several new properties of the H_2O^- defect were found and studied. One of them is the H_2O^- photodissociation at LNT by irradiation in the H_2O^- electronic absorption band, producing one U_2 and one OH⁻ center. The total oscillator strenght of the H_2O^- band in KCl ($f_{H_2O^-}=0.62$) was calculated by a comparative method. The structure of the H_2O^- band in the visible was decomposed and best fit by a sum of 5 gaussians. Changes with temperature of the relative intensities of the electronic transitions of the H_2O^- center were observed indicating possible modifications in the symmetry of the defect. An IR absorption band at 1410 cm⁻¹ in KCl: H_2O^- was assigned to the excitation of one local mode of the H_2O^- center. These experiments allowed we to formulation a structural model for the H_2O^- center that consists of a perturbed F center containing one OH molecule with one trapped hydrogen atom.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRUGGER, K. & MASON, W. P. Relation between therma' conductivity defect in sodium chloride and acoustic relaxation effects at low temperatures. Phys. Rev. Lett., 7(7):270-3, Oct. 1961.
- 2. CAPE, J. A. Photochemically produced color centers in KCl and KBr. Phys. Rev., <u>122</u>(1):18-25, Apr. 1961.
- 3. CHAE, D. G. & DICK, B. G. J. Phys. Chem. Sol., <u>34</u>:1683, 1973.
- CHAU, C. K.; KLEIN, M. V.; WEDDING, B. Photon and phonon interactions with OH⁻ and OD⁻ in KCl. Phys. Rev. Lett., <u>17</u>(10):521-5, Sep. 1966.
- DELBECQ, C. J.; SMALLER, B.; YUSTER, P. H. Paramagnetic resonance investigation on irradiated KCl crystals containing U-Centers. Phys. Rev., 104(3):599-606, Nov. 1956.
- ETZEL, H. W. & PATTERSON, D. A. Optical properties of alkali halides containing hydroxyl ions. *Phys. Rev.*, <u>112</u>(4):1112-6, Nov. 1958.
- 7. FISCHER, F. Z. Phys., 187:268, 1965.
- 8. FISCHER, F. Z. Phys., 204:351, 1967.
- 9. FRITZ, B. J. Phys. Chem Sol., 23:375, 1962.
- 210. FRITZ, B.; LUETY, F.; ANGER, J. The influence of OH⁻ ions on the absorption spectrum and ionic conductivity of KCl single crystals. Z. Phys., <u>174</u>:240-56, 1963.
- 11. HARTEL, H. & LUTY, F. Phys. Stat. Solid, 12:347, 1965.
- HAUSMANN, A. Electron spin resonance in alkali halide crystals containing sulfur and selenium. Z. Phys., 192:313-28, 1966.
- 13. KABLER, M. N. In: CRAWFORD JR, J. H., ed. Point defects in solids, v.1. New York, N. Y., Plenum, 1972. cap.4.
- 14. KANZIG, W.; HART JR., H. R.; ROBERTS, S. Paraelectricity and ferroelectricity due to hydroxyl ions in alkali halides; paraelectric cooling. *Phys. Rev. Lett.*, <u>13</u>(18):543-7, Nov. 1964.
- KAPPHAN, S. & LUTY, F. Study of the paraelectric behavior of OH⁻ ions in alkali halides with optical and caloric methods-I. Statics of dipole alignment. J. Phys. chem. Solids, <u>34</u>:969-87, 1973.
- 16. KAPPHAN, S. E. A study of paraelectric defects in alkali halides crystals with and optical and caloric methods. Utah, 1970. (Tese de doutoramento).
- 17. KERKOFF, F. Z. PHYS., 158:595, 1960.
- KLEIN, M. V. Phonon scattering in sodium chloride containing oxygen. Phys Rev., <u>122</u>:1393-402, Jun. 1961.
- 19. KNOX, R. S. Theory of excitions. Sol. stat., 5(Suppl.):62, 1963.
- 20. KOSTLIN, H. Solid State Comm., 3:81, 1965.
- 21. KOSTLIN, H. Z. Phys., 204:290, 1967.
- 22. KUHN, U. & LUTY. F.Solid State Comm., 2:281, 1964.
- 23. KURZ, G. OH⁻ Dissociation and decomposition in hydroxide-doped KCl and KBr crystals. Phys. Status Solidi, <u>31</u>:93-106, 1969.
- 24. LUTY, F. J. Phys. Chem. Sol., 23:677, 1962.
- 25. MARTIENSSEN, W. J. Phys. Chem. Sol., 2:257, 1957.
- 26. MORATO, S. P. Photodecomposition and reactions of hydroxyl and hydrogen defects in potassium chloride crystals. Utah, 1975. (Tese doutoramento).
- 27. NOWICK, A. S. & HELLER, W. R. Anelasticity and stress-induced ordering of point defects in crystals. Adv. Phys., 12(47):251-98, Jul. 1963.
- 28. PATTERSON, D. A. & KABLER, M. N. Solid State Comm., 3:75, 1965.
- 29. POOLEY D. & SIBLEY, W. A. Color centers and rediction demoge. Harwell, Berks, Engl., Atomic Energy Authority. Research Group. Atomic Energy Research Establishment, 1973. (AERE-R-7347).
- 30. ROBERTSON, J. A. L. Irradiation effects in nuclear fuels. New York, N. Y., Gordon and Breach Science, 1969.
- 31. ROLFE, J. Hydroxide absorption band alkali halide crystals. Phys Rev. Lett., 1(2):56-8. Jul 1958.
- 32. RUSCH, W. & SEIDEL, H. The H₂O⁻ centre in KCl: and F-Licke paramagnetic and paraelectric defect. *Phys. Status Solidi, B*, <u>63</u>:183-95, 1974.

66

- 33. RUSCH, W. & SEIDEL, H. Solid State Comm., 2:231, 1971.
- 34. SCHAEFER, G. The IR-spectrum of the U-center. Physics Chem. Solids, 12:233-44, 1960.
- 35. SONDER, E. & SIBLEY, W. A. defect creation by radiation in polar crystals. In CRAWFORD JR., J. H., ed. Point defects in solids, v. 1. New York, N. Y., Plenum, 1972. p. 201-90.
- 36. SPAETH, J. M. Z. Phys., 192:107, 1966.
- 37. TIMUSK, T. & MARTIENSSEN, W. Z. Phys., 176:305-12, 1963.
- 38. TOYOZAWA, Y. In: PROCEEDINGS of the 1974 International conference on Color Center in Ionic Crystals, Sendai Japan. Is.n.t.l
- 39. ZIBOLD, G. Kerr effect in alkali halides due to para-electric defects. Utah, 1971. (Tese doutoramento).



INSTITUTO DE ENERGIA ATÔMICA Caixa Postal, 11049 — Pinheiros CEP 05508 01000 — São Paulo — SP

Telefone: 211-6011 Endereço Telegráfico – IEATOMICA Telex – 011-23592 IENA BR